

CARACTERIZACIÓN DE TRANSISTORES HEMT EN BANDA Q

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL ELÉCTRICO

FRANCISCO JOSÉ NAVARRETE MORENO

PROFESOR GUÍA: SR. PATRICIO MENA MENA

MIEMBROS DE LA COMISIÓN: SR. NICOLÁS REYES GUZMÁN SR. LEONARDO BRONFMAN AGUILO

> SANTIAGO DE CHILE JULIO 2011

RESUMEN DE LA MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA POR: FRANCISCO NAVARRETE

FECHA: 18 DE JULIO DE 2011

PROF. GUÍA: SR. PATRICIO MENA MENA

"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN AMPLICADOR DE BAJO RUIDO BASADO EN TRANSISTORES DISCRETOS"

Este trabajo de título tiene como objetivo diseñar y construir un sistema de caracterización de transistores HEMT. Este sistema tiene como fin determinar el comportamiento de transistores candidatos a ser utilizados en el diseño de amplificadores de bajo ruido para receptores de antenas radioastronomicas que operen en Banda 1 del proyecto ALMA.

Como parte de este sistema se diseñaron y construyeron dos módulos, un módulo Bias Tee y un sistema de calibración TRL. El módulo Bias Tee permite mezclar, por un mismo canal, la señal proveniente del VNA y la polarización para entregarselas al transistor. El módulo de calibración TRL permite descontar de la medición de parámetros S del transistor, el efecto del resto de los elementos que forman el sistema de caracterización. Además, se desarrolló un software que a partir de los datos obtenidos del transistor calcula sus parámetros S.

Al realizar las mediciones del módulo Bias Tee y del sistema de calibración, estas diferían del comportamiento que mostraban las simulaciones. En el caso del Bias Tee se encontró que la mayor parte de la señal incidente en el módulo se refleja. En el caso del sistema de calibración, se genera una calibración exitosa pero altamente sensible a las modificaciones en el montaje, lo que no permite obtener una calibración estable para medir el transistor.

Al analizar los problemas descritos, se identificó que el elemento común en ambos módulos son los conectores 2.4 mm que se utilizan a la entrada y salida de ambos módulos. Se encontró que el montaje de estos conectores, que corresponde a un agujero recto en la pared del bloque de montaje, no es la más idónea. Como alternativa, se estudia un diseño que corresponde a un agujero cuyo radio varía de forma escalonada, llamado montaje de adaptación. Las simulaciones indican que las reflexiones son menores a $-20 \ dB$, lo que representa mejores resultados que el montaje simple.

En conclusión, este trabajo ha permitido identificar problemas no previstos en la caracterización del transistor de prueba. Se espera que al cambiar el método de montaje de los conectores 2.4 mm el sistema diseñado funcione correctamente.

Índice General

1.	\mathbf{Intr}	oducci	ón	8
	1.1.	.1. Antecedentes		
		1.1.1.	Antecedentes Generales	8
		1.1.2.	Antecedentes Específicos	10
	1.2.	.2. Objetivos		
		1.2.1.	Objetivos Generales	11
		1.2.2.	Objetivos Específicos	12
	1.3.	Estruc	tura del Informe	12
2.	Mar	co Teá	órico	1 4
	2.1. Conceptos Generales		ptos Generales	14
		2.1.1.	Líneas Microstrip	14
		2.1.2.	Parámetros S	15
		2.1.3.	Carta Smith	17
		2.1.4.	Ruido	18
	2.2.	Transi	stores de Alta Movilidad Electrónica HEMT	23
		2.2.1.	Descripción y Funcionamiento	23
		2.2.2.	Modelo equivalente	24
	2.3.	3. Caracterización de Transistores HEMT		
		2.3.1.	Obtención De Parámetros Extrínsecos	26
		2.3.2.	Obtención de Parámetros Intrínsecos	27
	2.4.	Calibra	ación TRL	29

		2.4.1.	Grafos de Flujo de Señales	29	
		2.4.2.	Concepto de Calibración	30	
		2.4.3.	Calibración TRL	31	
3.	Des	arrollo		36	
	3.1.	Descri	pción del Sistema de medición	36	
	3.2.	Transi	stor a Utilizar	38	
	3.3. Bias Tee			38	
		3.3.1.	Diseño del Bias Tee	40	
		3.3.2.	Construcción de Componentes	46	
		3.3.3.	Montaje del Bias Tee	51	
	3.4.	Bloque	e del Transistor	54	
	3.5.	Calibra	ación TRL	57	
		3.5.1.	Elección del Plano de Calibración	57	
		3.5.2.	Diseño y construcción de Standards	58	
		3.5.3.	Bloque de Calibración	59	
		3.5.4.	Incorporación de la Calibración al VNA	60	
	3.6.	Protoc	colo de Pruebas y Procesamiento de Datos	62	
		3.6.1.	Protocolo de Pruebas	62	
		3.6.2.	Procesamiento de Datos	63	
4.	Res	ultado	s y Análisis	64	
	4.1.	Bias T	'ee	64	
	4.2.	Calibra	ación TRL	66	
	4.3.	Anális	is de conectores 2.4 mm	70	
5 .	Con	clusio	nes	7 8	
Aı	Anexos				
Re	Referencias				

Índice de figuras

2.1.	Geometria Línea Microstrip	14
2.2.	Campos en Línea Microstrip	15
2.3.	Circuito de dos puertos con ondas incidentes y reflejadas	16
2.4.	Significado físico de paramtetros $S.$	17
2.5.	Gráfico Polar con coeficiente de reflexión para corto circuito, adaptación per-	
	fecta y circuito abierto	18
2.6.	Carta Smith círculos de igual resistencia	19
2.7.	Carta Smith estándar	20
2.8.	Ruido equivalente de un dispositivo de ganancia $G.$ (a) Dispositivo ruidoso.	
	(b) Dispositivo sin ruido	21
2.9.	Ruido en circuito receptor formado por elementos ruidosos en cascada	21
2.10.	Diagrama del Transistor HEMT	23
2.11.	Principio de Modulación de Dopaje en HEMT	24
2.12.	Circuito equivalente de pequeña señal de un HEMT representado sobre el	
	dispositivo físico.	25
2.13.	Circuito equivalente de pequeña señal del transistor HEMT	26
2.14.	Circuito equivalente de pequeña señal del transistor HEMT a $V_{gs}=0.$	26
2.15.	Método para extraer la matriz Y intrínseca del transistor	28
2.16.	Representación en grafo de flujo de señales de una red dos puertos	30
2.17.	Diagrama de Bloques de medición en VNA de un dispositivo de dos puertos.	31
2.18.	Diagrama de Bloques Calibración TRL	32

2.19.	Diagrama de Bloques y grafos de flujos de señales de standards de calibración	
	TRL. (a) Throu. (b) Reflect. (c) Line	35
3.1.	Diagrama de conexión del sistema de medición.	37
3.2.	Conectores. (a) 2.4 mm macho. (b) 2.4 mm hembra. (c) SMA hembra	38
3.3.	Esquema de transistor p Hem t EC2612 con dimensiones físicas en $\mu m.$	39
3.4.	Diagrama de bloques del filtro Bias Tee	40
3.5.	Renderización del modelo en HFSS del Bias Tee	41
3.6.	Renderización de los Filtros del Bias Tee en mayor detalle. (a) Filtro pasa	
	altos. (b) Filtro pasa bajos	42
3.7.	Diagrama circuital del Bias Tee	43
3.8.	Simulación de Bias Tee en HFSS, con gap de 6 mil , para valore de C_1 de 0.1,	
	0.4 y 1 pF	45
3.9.	Simulación de Bias Tee en HFSS, con gap de 8 mil , para valore de C_1 de 0.1,	
	0.4 y 1 pF	46
3.10.	Simulación de Bias Tee en HFSS, con gap de 10 mil , para valore de C_1 de 0.1,	
	0.4 y 1 pF	47
3.11.	Diagrama de montaje de conector en pared del bloque de duraluminio	48
3.12.	Fotografía de las líneas microstrip fabricadas.	50
3.13.	Fotografía de las líneas microstrip montadas sobre el bloque de duraluminio.	53
3.14.	Fotografía de condensadores y líneas montados sobre el bloque de duraluminio.	55
3.15.	Diagrama que muestra el plano de calibración TRL en el bloque del transistor.	57
3.16.	Fotografía del bloque del sistema de calibración con un bloque removible acom-	
	plado	59
4.1.	Gráfico de parámetros S del Bias Tee. Conectores 2.4 mm	65
4.2.	Gráfico de parámetros S de línea de 50 $\Omega.$ Conectores 2.4 mm	66
4.3.	Gráfico de parámetros S del $standard\ Thru$ bajo calibración estándar	67
4.4.	Gráfico de parámetros S del standard Thru tras la calibración TRL	68

4.5.	Gráfico de parámetros S del $standard\ Thru$ tras la calibración TRL, al reco-	
	nectar el puerto 2	69
4.6.	Diagrama de montaje de conectores 2.4 mm. (a) montaje simple. (b) montaje	
	de adaptación	70
4.7.	Renderización del modelo en HFSS del conector 2.4 mm en configuración simple.	71
4.8.	Renderización del modelo en HFSS del conector 2.4 mm en configuración de	
	adaptación	72
4.9.	Gráfico de parámetros S de la simulación del conector $2.4~\mathrm{mm}$ en configuración	
	simple	73
4.10	. Gráfico de parámetros S de la simulación del conector 2.4 mm en configuración	
	de adaptación	74
4.11	. Gráfico de parámetros S_{11} de la simulación del conector 2.4 mm en configu	
	ración simple, ante variaciones de su alineamiento vertical y horizontal con	
	respecto a la línea.	75
4.12	. Gráfico de parámetros S_{11} de la simulación del conector 2.4 mm en configura-	
	ción de adaptación, ante variaciones de su alineamiento vertical con respecto	
	a la línea	76

Capítulo 1

Introducción

1.1. Antecedentes

1.1.1. Antecedentes Generales

La necesidad de conocer más, de ampliar el entendimiento del universo, de no conformarse con lo desconocido, es una de las características más definitorias del ser humano. El hombre no fue capaz de aceptar la simplicidad del ser, si no que se planteó dudas sobre la finalidad de su existencia, sobre como funciona el mundo a su alrededor, sobre las leyes que lo rigen y sobre lo que hay más allá de su entorno inmediato.

A medida que el hombre ganaba más conciencia sobre su entorno, empezó a generar mapas. en un principio fue por motivos prácticos, luego, el motivo cambió. Ya no sólo quería
referenciar recursos, como alimentos, agua y minerales, ahora buscaba expandir su mundo,
sus conocimientos y su entendimiento. Esto se puede ver en el descubrimiento de América. Si
bien los financiamientos y la aceptación mundial de la exploración estuvieron muy motivados
por las expectativas de ganancia económica, los primeros hombres, los que encendieron la
chispa del viaje, los que querían cambiar los preceptos sobre la morfología terráquea, estos
hombres tenían como motivación la más pura y desesperada sed de conocimiento, curiosidad
desbordada, que los llevo a promover, impulsar y gestar tales viajes.

Mucho antes que el descubrimiento de América, 6000 años antes o más, el hombre ya ex-

ploraba con la vista y construía mapas de la bóveda celeste. En la actualidad con la superficie terrestre ampliamente explorada, el hombre centra aun más su atención en espacio exterior, ya no quiere saber sólo donde se encuentran los objetos fuera del planeta, o donde se encuentra el planeta dentro del sistema, si no que quiere saber de que están compuestos y cómo se formaron, quiere saber si las leyes que rigen dentro del planeta son las mismas que rigen en el universo completo. Una evidencia de aquello es que en este momento se han establecido los proyectos para fabricar los observatorios astronómicos más grandes jamás realizados.

Las técnicas de observación utilizadas en la antigüedad han ido variado, al principio sólo se observaba hacia el cielo, se establecían un conjunto de puntos brillantes como referencia, y se mapeaba los astros referenciados a otros astros, observando que éstas podían ser usadas para orientarse en la Tierra. Con la invención del telescopio en el siglo XVII fue posible observar con más detalle el cielo, ir graduando la separación de estrellas y hacer un registro de sus órbitas. El telescopio fue evolucionando y aumentando de tamaño, hoy en día se tienen grandes construcciones que contienen precisos telescopios con varios espejos operando en conjunto. Las técnicas de observación se han ampliado, en la actualidad no sólo se tienen telescopios ópticos, sino que también, desde 1931 Gracias al descubrimiento de Jansky, radiotelescopios, que recibiendo ondas electromagnéticas puede conocer las partículas que las emitieron.

El Atacama Large Milimiter Array (ALMA), es el proyecto más grande de radioastronomía que ha existido y en este momento se construye en la región de Atacama de Chile. Éste consiste en un arreglo de 66 telescopios que trabajaran en conjunto para, por medio de interferometría, obtener mejor resolución de las ondas provenientes del espacio y así poder recibir ondas muy débiles de lugares muy lejanos del universo.

Las ondas provenientes de los lugares más lejanos del espacio varían significativamente su frecuencia en su viaje a la Tierra, esto se debe al efecto doppler. Las frecuencias de estas ondas disminuyen, por lo que se que tienen un alto corrimiento al rojo. En el proyecto ALMA, la banda donde se perciben estos objetos es llama banda 1, y corresponde a frecuencias entre los 30 y los 45 GHz.

1.1.2. Antecedentes Específicos

El Grupo de Instrumentación Astronómica perteneciente al Departamento de Ingeniería Eléctrica (DIE) y al Departamento de Astronomía (DAS) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, trabaja para proveer al proyecto ALMA de receptores de antenas que capten ondas electromagnéticas en banda 1 (30-45 Ghz). Dado que las señales que se captan son de muy baja intensidad, es necesario aplicar varias etapas de amplificación en el receptor para asegurar que la señal no se pierda por el ruido que se produce en la etapa de recepción. Para cumplir con estos objetivos de amplificación, ALMA ha establecido criterios muy estrictos en cuanto al ruido aceptado en estas etapas. Así, los amplificadores de bajo ruido que se encuentran en el mercado no satisfacen todos lo requerimientos del proyecto, lo que propende al Grupo de Instrumentación Astronómica a buscar soluciones no comerciales a este problema.

Ante estas condiciones, el Grupo de Instrumentación Astronómica experimenta con distintas soluciones, entre las que se cuentan: realizar pruebas de montaje de amplificadores para reducir el ruido que pueda añadir este proceso, probar distintos tipos de tecnologías de amplificación de bajo ruido utilizando soluciones comerciales avanzadas y fabricar amplificadores de bajo ruido que cumplan con los requerimientos. Dentro de este último enfoque, las dos tareas principales son: encontrar un diseño de amplificador adecuado y encontrar los elementos óptimos para construir el diseño. Dado que el elemento que más influye en el ruido de un amplificador es el transistor, es en estos semiconductores donde esta el foco de diseño. El examinar distintas tecnologías permitirá establecer que tipo de transistores son los más apropiados para los requerimientos, para esto se requiere conocer el modelo de circuito

equivalente de cada transistor a utilizar a modo de simular y establecer comparaciones entre distintos dispositivos.

Es imperativo entonces, tener una metodología de caracterización de transistores que permita tener mediciones propias del comportamiento de estos dispositivos. Esto por un lado para no depender de los datasheet del fabricante y por otro lado para trabajar con semiconductores que no han sido medidos aún.

En esta memoria se documentara el proceso de diseño y construir un sistema de caracterización enfocado en transistores HEMT, acotado entre 30 y 50 Ghz. Este sistema estará basado en líneas microstrip montadas en bloques de aluminio, interconectados por cable coaxial. El sistema de caracterización estará compuesto por el bloque donde estará montado el transistor; un Vector Network Analyser (VNA) para realizar las mediciones; un par de filtros Bias Tee que permiten ingresar la señal y la polarización al transistor por un mismo canal; un sistema de calibración TRL que permitirá descontar los errores introducidos al medir el transistor por las etapas que conectan a éste con el VNA, tales como cables, conectores, adaptadores y Bias Tee; y un sofware que a partir de los parámetros S obtenidos, calculara el modelo equivalente del transistor.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivos Generales

- Dotar las antenas del proyecto ALMA de la instrumentación necesaria para operar.
- Diseñar y construir receptores de antena para cada una de las 10 bandas del proyecto ALMA.
- Desarrollar un prototipo de receptor de banda 1 para antenas del proyecto ALMA, que cumpla con las especificaciones establecidas.

- Probar distintos amplificadores que puedan ser utilizados en el receptor.
- Construir un amplificador basado en tecnología HEMT que pueda ser utilizado en el receptor.
- Examinar distintos transistores HEMT, y comprobar la factibilidad de utilizarlos para fabricar el amplificador mencionado.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Caracterizar distintos transistores HEMT.
- Establecer y construir un método de pruebas, y desarrollo de datos que permita caracterizar transistores HEMT.
 - Establecer protocolo de pruebas.
 - Diseñar y construir infraestructura de pruebas.
 - Diseñar y construir filtros Bias Tee que permitan juntar la polarización proveniente de la fuente y las señales pequeñas provenientes del VNA para que lleguen al transistor por el mismo canal Microstrip.
 - Realizar un programa en MATLAB que procese los datos de las pruebas y entregue el circuito equivalente del transistor medido.

1.3. Estructura del Informe

En el capitulo 1 se puede leer la introducción y objetivos de la memoria que la contextualizan al tiempo que lo describen brevemente. El capitulo 2 explica los conceptos más importantes utilizados en el documento, al tiempo que expone la teoría detrás del sistema de calibración. El capitulo 3 se encarga de detallar el proceso de diseño y construcción de cada uno de los elementos del sistema. El capitulo 4 muestra los resultados obtenidos. Finalmente,

el capitulo 5 expone las conclusiones del trabajo realizado, discutiendo los temas que quedaron inconclusos, que pueden ser mejorados, y líneas de trabajo futuras.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Conceptos Generales

2.1.1. Líneas Microstrip

La línea microstrip es una de las líneas de transmisión plana más utilizadas, básicamente por que es fácil de fabricar usando fotolitografía a la vez que es fácil de integrar con otros elementos microondas. Como se puede ver en la figura 2.1, una línea microstrip está compuesta por un conductor de ancho W impreso en un dieléctrico delgado de altura d. La superficie contraria a donde se ubica el conductor en el dieléctrico está cubierto por una placa metálica que constituye la tierra.

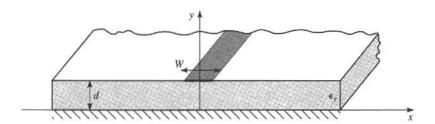


Figura 2.1: Geometria Línea Microstrip.

Si bien la mayoría de las líneas de campo en una línea microstrip se concentran en el dieléctrico, como se ve en la figura 2.2, algunas utilizan el aire como medio. Dado que ambos

medios tiene distintas velocidades de fase, no se puede formar un modo TEM en esta geometría. El comportamiento, es de hecho, un híbrido TM-TE pero dado que el dieléctrico es muy delgado, se comporta como un modo cuasi-TEM. Así la velocidad de fase y la constante de propagación se puede expresar de la siguiente manera [1].

$$v_p = \frac{C}{\sqrt{\epsilon_e}} \tag{2.1}$$

$$\beta = K_0 \sqrt{\epsilon_e} \tag{2.2}$$

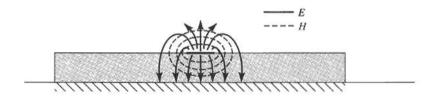


Figura 2.2: Campos en Línea Microstrip.

2.1.2. Parámetros S

Los Parámetros S o Parámetros de Scattering (dispersión), es una forma de representar un circuito en términos de que cantidad de una señal se dispersa cuando incide en el circuito. La representación de un circuito en parametros S se llama matriz de scattering o matriz S. La figura 2.3 representa un circuito de dos puertos, donde V_{i1} y V_{r1} representan respectivamente, los voltajes de las ondas incidente y reflejada en el puerto 1, V_{i2} y V_{r2} , los voltajes de las ondas incidente y reflejada en el puerto 2. La potencia que incide en el puerto 1 dada por la ecuación 2.3 puede ser usada para definir una nueva variable a_1 , de la misma forma la potencia reflejada en el puerto 2 puede ser usada para definir b_1 en la ecuación 2.4, y de la misma manera se definen a_2 y b_2 en el puerto 2. Con ésto se puede obtener el voltaje y la corriente total en el puerto 1 dado por las ecuaciones 2.5 y 2.6 [2].

$$P_{incidente}(1) = \frac{|V_{i1}|^2}{Z_0} = |a_1|^2 \tag{2.3}$$

$$P_{reflejada}(1) = \frac{|V_{r1}|^2}{Z_0} = |b_1|^2 \tag{2.4}$$

$$V_1 = \sqrt{Z_0}(a_1 + b_1) \tag{2.5}$$

$$I_1 = \frac{(a_1 - b_1)}{\sqrt{Z_0}} \tag{2.6}$$

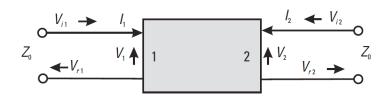


Figura 2.3: Circuito de dos puertos con ondas incidentes y reflejadas.

Luego acudiendo a las mismas ecuaciones para el puerto 2, y resolviendo el sistema dejando b_1 y b_2 como variables dependientes, y a_1 y a_2 como variables independientes, se obtiene la matriz de scattering para un circuito de dos puertos dada por 2.7.

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

$$(2.7)$$

Los elementos de la matriz S tiene significado físico: S_{ij} corresponde a la amplitud y fase del voltaje de la señal de salida en el puerto i con respecto al voltaje de la señal de entrada en el puerto j; S_{ii} corresponde al voltaje de la señal de salida del puerto i con respecto al voltaje de la señal de entrada del puerto i. En terminos más simples, S_{ij} representa la cantidad de señal transmitida del puerto j al puerto i, mientras que S_{ii} representa la cantidad de señal reflejada por el puerto i. Ésto se puede ver en el caso de un circuito de 2 puertos en la figura 2.4.

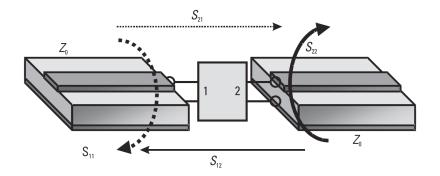


Figura 2.4: Significado físico de paramtetros S.

2.1.3. Carta Smith

La carta smith es un método gráfico que sirve no sólo para representar impedancias y coeficientes de reflexión, si no que para transformar gráficamente entre éstos. Su característica principal es ser capaz de mostrar todos los posibles coeficientes de reflexión, impedancias y admitancias de un circuito pasivo en un gráfico finito.

Si se considera una línea de impedancia Z_0 terminada en una carga de impedancia Z_L , el coeficiente de reflexión Γ dado por la ecuación 2.8 sera un valor complejo que puede ser representado en un gráfico polar, como muestra la figura 2.5. Se puede ver en la ecuación 2.8 que si la carga se adapta totalmente a la línea, se tendrá un punto en el centro de la carta smith para representar a Z_L , si la carga es un cortocircuito entonces se tendrá un punto dibujado al extremo izquierdo del gráfico, y si es un circuito abierto, se tendrá un punto en el lado derecho. Los circulos concentricos representan líneas de igual magnitud de coeficiente de reflexión.

$$\Gamma = (Z_L - Z_0)/(Z_L + Z_0) \tag{2.8}$$

La carta smith contiene ademas círculos de igual resistencia normalizada, las que tienen un lado adyacente al extremo derecho del diagrama smith que representa el circuito abierto

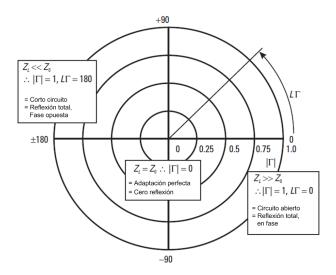


Figura 2.5: Gráfico Polar con coeficiente de reflexión para corto circuito, adaptación perfecta y circuito abierto.

de impedancia infinita, el cortocircuito esta al extremo izquierdo, y la adaptación perfecta corresponde al centro del diagrama smith, como se puede ver en la figura 2.6. De la misma forma se pueden graficar círculos de igual admitancia que serán adyacentes al lado izquierdo de la carta smith. En la figura 2.7 se puede ver una carta smith estándar que incluye las líneas de igual reactancia, que van desde los bordes del diagrama hacia el punto de circuito abierto [2].

2.1.4. Ruido

El ruido afecta de manera significativa los sistemas de recepción en microondas, definiendo el nivel más débil de señal que podrá ser capturado. Hay dos fuentes de ruido en un sistema de recepción, el ruido captado por la antena y el ruido intrínseco del circuito receptor. El primero se compone por todas las fuentes de ruido que llegan a la antena junto con la señal de interés, tales como los astros cercanos como el Sol y la Luna, las distintas capas de la atmósfera terrestre y tormentas cósmicas entre otras. El ruido intrínseco de un circuito se debe al movimiento aleatorio de electrones en un material debido a la temperatura de éste. El ruido que ingresa por la antena se amplifica o pierde en la misma proporción que la señal

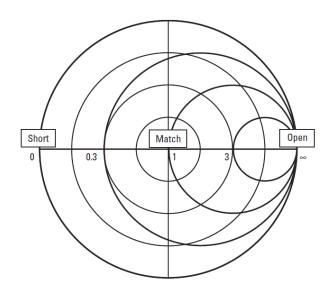


Figura 2.6: Carta Smith círculos de igual resistencia.

de interés al pasar por el circuito receptor, por lo que la relación señal ruido de la antena no puede ser modificada por el receptor. La mejor forma de tratarlo es haciendo un diseño eficiente de antena y eligiendo un buen lugar donde colocarla. El ruido intrínseco del circuito receptor se ira sumando al ruido de entrada deteriorando la relación señal-ruido dentro del receptor. La forma de tratarlo es utilizando en la primera etapa de recepción un amplificador de bajo ruido.

Potencia de Ruido

La potencia de ruido efectiva n [W] generada por un dispositivo es directamente proporcional a la temperatura física T [K] y el ancho de banda de ruido considerado B_n [Hz], como se ve en la ecuación 2.9. En el caso que el elemento aplique una amplificación o disipación de la señal de entrada a la salida, esta formula cambia a 2.10, donde G representa la ganancia o perdida del elemento.

$$n = kTB_n[W] (2.9)$$

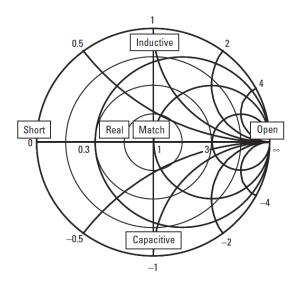


Figura 2.7: Carta Smith estándar.

$$n = GkTB_n[W] (2.10)$$

Donde $k=1,379\times 10^{-23}[W/HzK]$ es la constante de boltzmann.

Temperatura de Ruido Equivalente

A un componente ruidoso que genera una temperatura de ruido N_0 a su salida como el que se ve en la figura 2.8 (a), se le puede definir una temperatura de ruido equivalente T_e , que aplicada a la resistencia de fuente a la entrada del dispositivo, genera la misma potencia de ruido N_0 a la salida del este. El dispositivo en este caso se considera sin ruido como aparece en la figura 2.8 (b). T_e esta dada por la ecuación 2.11.

$$T_e = \frac{N_0}{GkB}[K] \tag{2.11}$$

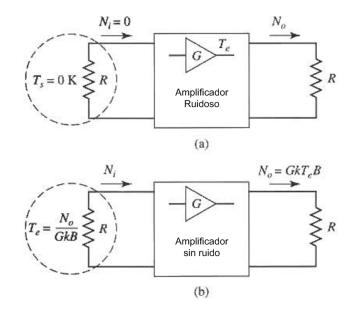


Figura 2.8: Ruido equivalente de un dispositivo de ganancia G. (a) Dispositivo ruidoso. (b) Dispositivo sin ruido.

Ruido en Circuito en Cascada

Si la entrada de un dispositivo ruidoso de temperatura de ruido equivalente T_e y ganancia G, esta conectada a una fuente de ruido con temperatura de ruido equivalente T_{in} , la potencia de ruido a la salida estará dada por la ecuación 2.12.

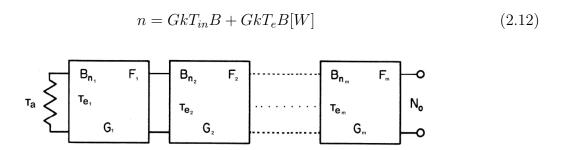


Figura 2.9: Ruido en circuito receptor formado por elementos ruidosos en cascada.

Ahora se analizará un circuito formado por elementos en cascada, con una fuente de ruido conectada a la entrada, tomando como ejemplo un sistema de recepción. En este caso el cir-

cuito en cascada representa el circuito receptor y la fuente de ruido a la entrada representa el ruido proveniente de la antena. Este circuito se ve en la figura 2.9, donde T_a es la temperatura equivalente de ruido de la antena a la entrada del circuito receptor, G_i es la ganancia de la etapa i, B_i es el ancho de banda de cada etapa, y T_{e_i} es la temperatura de ruido equivalente de la etapa i. El ruido a la salida del sistema N_0 esta dado por la ecuación 2.13, donde T_e representa la temperatura de ruido equivalente del sistema completo dado por la ecuación 2.14, donde T_r representa la temperatura de ruido del circuito receptor dado por la ecuación 2.15.

$$N_0 = \prod_{i=1}^{m} G_i k T_e (2.13)$$

$$T_e = T_a + T_r \tag{2.14}$$

$$T_r = T_{e_1} + \frac{T_{e_2}}{G_1} + \frac{T_{e_3}}{G_1 G_2} + \dots + \frac{T_{e_m}}{\prod_{i=1}^{m-1} G_i}$$
 (2.15)

Como se puede ver en las ecuaciones 2.14 y 2.15 la temperatura equivalente del sistema esta dada principalmente por el ruido de la antena y el ruido intrínseco de la primera etapa del circuito receptor, ya que el ruido de la segunda etapa se ve disminuido por la ganancia de la primera etapa, y el ruido de la tercera etapa se ve disminuido por las ganancias de la primera y segunda etapa. De este modo, los mejores esfuerzos en diseñar una etapa de buena ganancia y bajo ruido deben estar enfocados en la primera etapa, donde se obtendrá un beneficio mayor, mientras que las ultimas etapas no son preponderantes en el ruido del sistema [1].

2.2. Transistores de Alta Movilidad Electrónica HEMT

2.2.1. Descripción y Funcionamiento

El Transistor de Alta Movilidad Electrónica o HEMT (High Electron Mobility Transistor) es una tecnología de transistores desarrollada para operar con longitudes de onda milimétricas. Sus características principales son operar a alta frecuencia, hasta el orden de 100 GHz, y su bajo ruido, por lo que es muy utilizado en LNA (Low Noise Amplifiers). Su funcionamiento esta basado en el Transistor de Efecto de Campo o FET (Fild Effect Transistor), con la particularidad de que el canal de conducción en vez de formarse en el substrato, se forma entre dos capas de material con distinta banda prohibida (bandgap) formando entra ambos una heterounión (heterojunction), por lo que es también llamado HFET (Heterostructure FET). En la figura 2.10 se puede ver como se estructura un HEMT.

Al tener n^- AlGaAs un bandgap mayor a GaAs, se produce un pozo cuántico (Quantum Well) en la banda de conducción de la heterounión. Los electrones de n^- AlGaAs se difunden en el pozo cuántico generando un gas de dos dimensiones confinado en la juntura, en este gas los electrones tiene gran movilidad, lo que provoca que al ser utilizado como canal, el gas produce un transistor de alta frecuencia y muy bajo ruido.

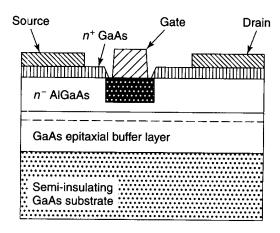


Figura 2.10: Diagrama del Transistor HEMT.

La Generacion de este gas se debe al principio de dopaje modulado (Modulation Doping Principle), donde las cargas libres de una región altamente dopada se difunden en una región menormente dopada, donde son capaces de moverse con gran movilidad por el menor efecto del scattering debido a las impurezas, las que son menores en la región menormente dopada. En la figura 2.11 se puede ver como se forma el gas en dos dimensiones entre los dos materiales en un transistor HEMT, donde 2DEG representa al gas de dos grados de libertad [1], [3].

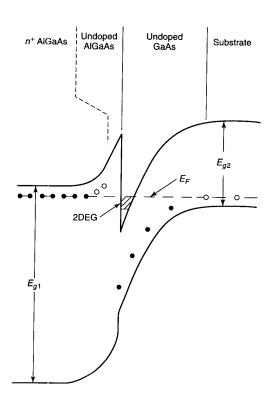


Figura 2.11: Principio de Modulación de Dopaje en HEMT.

2.2.2. Modelo equivalente

Los parámetros del modelo equivalente de pequeña señal de un transistor, pueden ser divididos en dos grupos, los extrínsecos y los intrínsecos. El modelo de un transistor HEMT puede ser visto en la figura 2.13 donde se muestran ambos grupos de parámetros. En la figura 2.12 se pueden ver estos parámetros representados sobre el dispositivo físico.

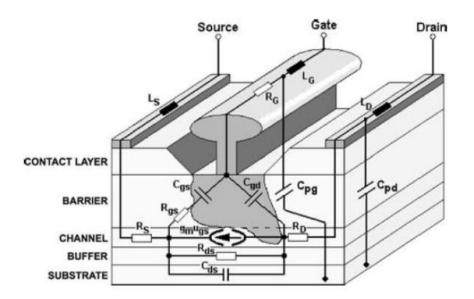


Figura 2.12: Circuito equivalente de pequeña señal de un HEMT representado sobre el dispositivo físico.

Los parámetros extrínsecos son independientes de la polarización del dispositivo, y dan cuenta de los fenómenos físicos que se manifiestan en las capas más externas del transistor. Las inductancias parásitas L_s , L_g y L_d representan respectivamente el efecto de inducción que se produce debido al contacto metálico de los pads en Source, Gate y Drain, las resistencias parásitas R_s y R_d representan la resistencia debido a los contactos ohmicos y R_g representa la resistencia de metalización, C_{pg} representa la capacitancia que se produce entre el pad del Gate y tierra, y C_{pd} la que se genera entre Drain y tierra.

Los parámetros intrínsecos dan cuenta de los fenómenos físicos en el interior del transistor, por lo que están ligados con el funcionamiento de éste, siendo dependientes de la polarización del dispositivo. C_{gs} y C_{gd} son debido a cargas de deplexión y C_{ds} es la capacitacia geométrica entre Drain y Source; g_m y g_d son transconductancias vinculadas a las corrientes al interior del dispositivo; τ es el desface de la transconductancia, dado que la corriente no responde inmediatamente a los cambios de voltaje del Gate; R_i de cuestionable representación física fue introducido para mejor el modelo dado los valores de S_{11} [4], [5].

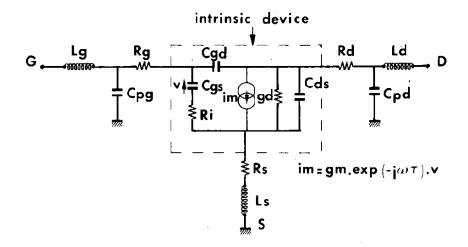


Figura 2.13: Circuito equivalente de pequeña señal del transistor HEMT.

2.3. Caracterización de Transistores HEMT

Existen diferentes métodos para obtener el modelo equivalente de señal pequeña de un transistor HEMT. El utilizado en este trabajo esta basado en [4], que consiste en medir los parámetros S del transistor bajo la condición $V_{ds} = 0$ para medir los parámetros extrínsecos, aprovechando su independencia de la polarización. Luego estos parámetros son excluidos de la matriz S medida bajo polarización operacional, mediante un calculo de deembed para que ésta represente sólo al modelo intrínseco.

2.3.1. Obtención De Parámetros Extrínsecos

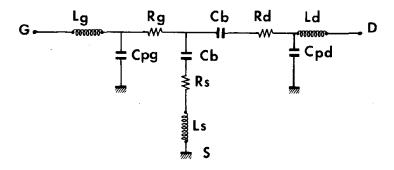


Figura 2.14: Circuito equivalente de pequeña señal del transistor HEMT a $V_{gs}=0.$

En la figura 2.14 se puede ver el modelo equivalente del transistor bajo condiciones de $V_{ds} = 0$, donde Z_{ij} esta representada por las ecuaciones 2.16, 2.17 y 2.18.

$$Z_{11} = R_s + R_g + \frac{R_c}{3} + \frac{nkT}{qI_q} + j\omega(L_s + L_g)$$
 (2.16)

$$Z_{12} = Z_{21} = R_s + R_c/2 + j\omega L_s \tag{2.17}$$

$$Z_{22} = R_s + R_d + R_c + j\omega(L_s + L_d)$$
(2.18)

Donde R_c es la resistencia de canal bajo el Gate, n es el factor de idealidad, k la constante de Boltzmann, T la temperatura e I_g la corriente del Gate.

De las expresiones anteriores se puede ver que la parte real de Z es independiente de la frecuencia, mientras que la parte imaginaria varia linealmente con esta. Luego se pueden obtener los parámetros resistivos aplicando parte real a las expresiones anteriores, y los inductivos aplicando parte imaginaria a estas.

Para obtener los valores de resistencias del circuito equivalente se debe medir I_g , y realizar el gráfico $Re(Z_{11})$ vs $1/I_g$. Ademas una relación adicional deber ser utilizada para encontrar R_c . Ésto no es problema por que existe redundancia de ecuaciones para resolver el sistema, que pueden ser encontradas en las referencias [5], [6] y [7] de [paper1]. Pero en la practica se pueden despreciar los términos R_c y $\frac{nkT}{qI_g}$ de modo que los cálculos sean más directos. Para obtener los parámetros se las inductancias, conviene utilizar la segundo derivada numérica de las partes imaginarias.

2.3.2. Obtención de Parámetros Intrínsecos

Con los parámetros extrínsecos ya obtenidos, se procede a polarizar de forma operacional, con lo que se obtendrá una matriz S de todo el transistor. Luego se realiza el deembed de los

parámetros extrínsecos. Para esto conviene trabajar con la matriz Y, debido a la topologia π del dispositivo.

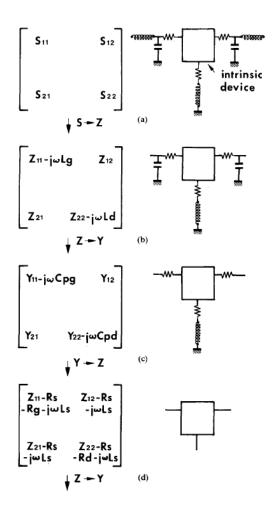


Figura 2.15: Método para extraer la matriz Y intrínseca del transistor.

En la figura 2.15 se ven los pasos que hay que aplicar a la matriz S medida, para aplicar el deembeding de los parámetros extrínsecos, y obtener la matriz Y resultante que representa los parámetros intrínsecos. Los pasos son:

- 1. Medir los parámetros S del dispositivo
- 2. Transformar Sa Zy restar L_g y L_d que son elementos serie

- 3. Transformar Z a Y y restar C_{pg} y C_{pd} que están en paralelo
- 4. Transformar Y a Z y restar R_g , R_s , L_s y R_d que estan en serie
- 5. Transformar Z a Y que corresponde a la matriz Y de los elementos intrínsecos

La matriz Y del circuito intrínseco del transistor puede escribirse como 2.19, 2.20, 2.21 y 2.22. De estas ecuaciones se pueden calcular los parámetros intrínsecos.

$$Y_{11} = R_i C_{qs}^2 \omega^2 + j\omega (C_{qs} + C_{qd})$$
 (2.19)

$$Y_{12} = -j\omega C_{gd} \tag{2.20}$$

$$Y_{21} = g_m - j\omega(C_{qd} + g_m(R_iC_{qs} + \tau))$$
(2.21)

$$Y_{22} = g_d + j\omega(C_{ds} + C_{gd}) (2.22)$$

De esta forma se ha obtenido la caracterización completa del transistor. Dado que los parámetros intrínsecos dependen de la polarización, este ultima etapa de la caracterización deber ser repetida para varios punto de operación en que se quiera conocer el circuito equivalente del dispositivo, y obtener curvas de estos dependientes de la polarización.

2.4. Calibración TRL

2.4.1. Grafos de Flujo de Señales

Los grafos de flujos de señales son la base de la calibración TRL, por lo que es necesario mencionarlos. Éstos son una técnica para representar redes de microonda por medio de ondas transmitidas y reflejadas. Cada puerto de la red es representado por dos nodos en el grafo,

donde uno se identifica con las ondas que entran al puerto, mientras que el otro con las ondas reflejadas en el puerto. El voltaje en cada nodo esta dado por la suma de las señales que ingresan en el. Los nodos están unidos por aristas con sentido, que representan el flujo de señales entre los nodos. Cada arista tiene relacionado un parámetro S o un coeficiente de reflexión. De esta forma una red de dos puertos puede ser presentada por un grafo de flujo de señales como se ve en la figura 2.16, donde por ejemplo una onda de voltaje a_1 que incide en el puerto 1, se divide entre una onda onda trasmitida hacia el puerto 2 por S_{21} y una onda reflejada a través de S_{11} .

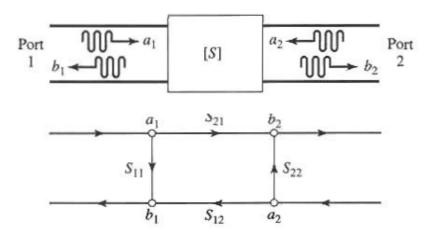


Figura 2.16: Representación en grafo de flujo de señales de una red dos puertos.

2.4.2. Concepto de Calibración

La caracterización de un circuito por medio de su medición se logra utilizando un Vector Network Analyzer (VNA), equipo que utiliza voltajes complejos, midiendo magnitud y fase de las señales, para obtener los parámetros S del circuito objetivo.

Un problema aparece al realizar estas mediciones debido a que el plano de referencia de los voltajes se encuentra al interior del VNA, por lo que cualquier medición incluirá las perdidas y desfases producidos por los cables, conectores y adaptadores que conectan el dispositivo a

medir (DAM) con el VNA. Ésto puede ser visto como el diagrama de bloques de la figura 2.17 donde un bloque representa al DAM, que esta conectado al VNA por medio de dos bloques de error que representan los elementos que conectan al DAM con cada puerto.

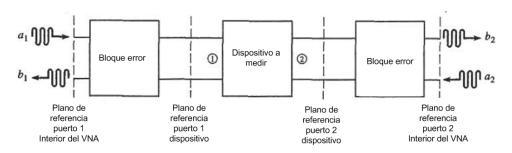


Figura 2.17: Diagrama de Bloques de medición en VNA de un dispositivo de dos puertos.

Hay una forma de extraer estos errores de la medición. El concepto de calibración consiste en caracterizar los bloques de error, para ser posteriormente restados matemáticamente a las mediciones del conjunto entero y así obtener los parámetros S del DAM aislado de errores. Las mediciones corregidas tendrán sus voltajes medidos con respecto a un nuevo plano de referencia llamado plano de calibración, el que se posiciona entre los dos bloques de error.

La forma mas simple de calibración es reemplazar el DAM por cargas conocidas llamadas standards, tales como cortocircuito, circuito abierto, o cargas bien adaptadas. Estos standards tienen parámetros S conocidos, de modo que se pueden ingresar manualmente al VNA para ser restados de la medición y de esta forma se puede obtener los parámetros S de los bloques de error. El problema con esta calibración es que estos standards son siempre imperfectos en cierto grado por lo que producen errores en la medición. Estos errores aumentan a frecuencias mayores, y a medida que se busca una medición de mayor calidad.

2.4.3. Calibración TRL

La calibración TRL no depende de standards conocidos por lo que el error introducido entre los parámetros ideales ingresados al VNA y los parámetros reales de cada standard

desaparecen. Utiliza tres simples conexiones Throu, Reflect y Line, que unen los bloques de error y permiten su caracterización sin tener que conocer por completo estos standards. La conexión Throu se logra conecta directamente los puertos en el plano de referencia deseado. Reflect se logra conectando una carga con alto indice de reflexión Γ_L a cada puerto. Estas cargas pueden ser un circuito abierto o un cortocircuito. Line consiste en conectar los puertos 1 y 2 a través de una línea de de la misma impedancia del sistema.

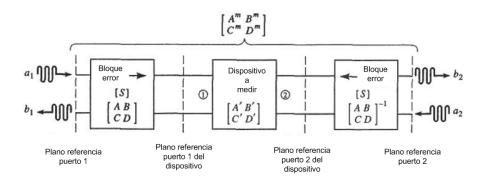


Figura 2.18: Diagrama de Bloques Calibración TRL.

El diagrama de bloques de la calibración TRL se ve en la figura 2.18. Se asume simetría entre los circuitos que conectan el VNA al DAM por cada puerto. De esta forma se obtiene dos relaciones, una es $S_{21} = S_{12}$, y la otra es la reciprocidad de las matrices ABCD de los bloques de error. Las matrices S de Throu, Reflect y Line serán llamadas respectivamente [T],[R] y [L].

Al insertar el Throu entre los planos de calibración se obtiene el diagrama de bloques de la figura 2.19 (a), con su respectivo grafo de flujo de señales. Del grafo se obtienen las ecuaciones 2.23 y 2.24, mientras que de la simetría y reciprocidad se obtienen las ecuaciones 2.25 y 2.26.

$$T_{11} = S_{11} + \frac{S_{22}S_{12}^2}{1 - S_{22}^2} \tag{2.23}$$

$$T_{12} = \frac{S_{12}^2}{1 - S_{22}^2} \tag{2.24}$$

$$T_{22} = T_{11} (2.25)$$

$$T_{21} = T_{12} (2.26)$$

De la misma forma al insertar el Reflect, se obtiene el diagrama de bloques y el grafo de flujo de señales de la figura 2.19 (b). Del grafo se obtiene la ecuación 2.27, de simetría se obtiene la ecuación 2.28, y notando que los puertos quedan desacoplados se obtiene la ecuación 2.29.

$$R_{11} = S_{11} + \frac{S_{12}^2 \Gamma_L}{1 - S_{22} \Gamma_L} \tag{2.27}$$

$$R_{22} = R_{11} (2.28)$$

$$R_{12} = R_{21} = 0 (2.29)$$

Finalmente al insertar Line se obtienen el diagrama de bloques y el grafo de flujo de señales de la figura 2.19 (c). Al igual que en el caso del T Del grafo se obtienen las ecuaciones 2.30 y 2.31, mientras que de reciprocidad y simetría se obtienen 2.32 y 2.33.

$$L_{11} = S_{11} + \frac{S_{22}S_{12}^2 e^{-2\gamma\ell}}{1 - S_{12}^2 e^{-2\gamma\ell}}$$
(2.30)

$$L_{12} = \frac{S_{12}^2 e^{-\gamma \ell}}{1 - S_{22}^2 e^{-2\gamma \ell}} \tag{2.31}$$

$$L_{22} = R_{11} (2.32)$$

$$L_{21} = R_{12} (2.33)$$

Con esto se obtienen 5 ecuaciones: 2.23, 2.24, 2.27, 2.30 y 2.31; y 5 incógnitas S_{11} , S_{22} , S_{12} , Γ_L y $e^{-\gamma \ell}$ que corresponde al factor de propagación. De aquí se pueden calcular los parámetros S de los bloques de error, con lo que concluye la calibración. Finalmente con los bloques de error caracterizados, al medir el dispositivo en la configuración de la figura 2.18 se estará midiendo la matriz $ABCD^m$ dada por 2.34. Luego los parámetros S del DAM dados por su matriz equivalente ABCD' se obtiene en la ecuación 2.35 donde se realiza el deembed de los bloques de error de la medición de todo el sistema.

$$ABCD^{m} = \begin{bmatrix} A^{m} & B^{m} \\ C^{m} & D^{m} \end{bmatrix}$$
 (2.34)

$$\begin{bmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} A^m & B^m \\ C^m & D^m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$
(2.35)

Se puede ver del método descrito, que no es necesario conocer Γ_L del standard Reflect, ni el largo, ni las perdidas de Line, ya que se determinan durante la calibración, al resolver el sistema de ecuaciones. Esto es la característica que hace confiable esta calibración cuando no se dispone de la precisión para crear los standards.

como cómo de pregunta

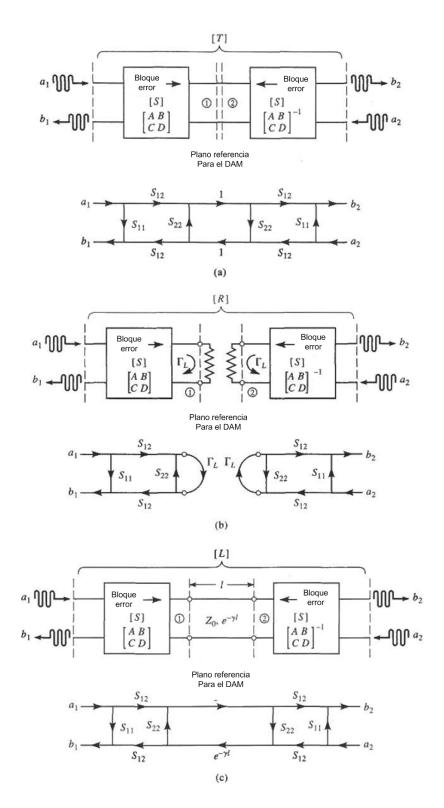


Figura 2.19: Diagrama de Bloques y grafos de flujos de señales de standards de calibración TRL. (a) Throu. (b) Reflect. (c) Line.

Capítulo 3

Desarrollo

3.1. Descripción del Sistema de medición

A continuación se da una descripción general del sistema de medición con el cual se obtienen los parámetros S del transistor, que posteriormente serán procesados para obtener la su caracterización. El diseño y construcción de los componentes de este sistema sera cubierto en detalle más adelante.

Las mediciones se efectúan con un VNA (Vector Network Analyzer) modelo E8364C de Agilent. Este equipo se utiliza para obtener los parámetros S de una red. Para esto envía señales alternas a los puertos del circuito y mide voltaje y fase de las señales que se reflejan o transmiten por el circuito y se devuelven al VNA. El VNA utilizado es de dos puertos, para medir redes de más puertos es necesario realizar más de un montaje de medición con el VNA.

En la figura 3.1 se ve el diagrama de bloques del sistema de medición. El puertos 1 del VNA se conectan por cable coaxial al puerto 1 del bloque Bias Tee 1, a este último ingresa además el voltaje continuo de la fuente de polarización por el puerto 3, ambos voltajes se mezclan al interior de este bloque para salir por el puerto 2 por medio de cable coaxial, que llega al puerto 1 del bloque del transistor. De manera simétrica se conecta el puerto 2 del VNA al puerto 2 del bloque del transistor. La única asimetría esta en que el puerto 1 del bloque del transistor se conecta al pad Gate del transistor, mientras que el puerto 2 de este

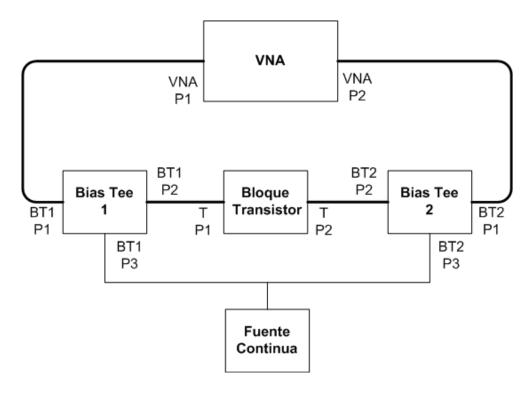


Figura 3.1: Diagrama de conexión del sistema de medición.

bloque se conecta al *pad Drain* del dispositivo. El resto de las conexiones son simétricas, lo que es importante en la calibración TRL como se vera más adelante. Por esto, es importante que ambos bloques Bias Tee sean construidos lo más semejantemente posible.

Las señales viajan en los bloques del transistor y los de Bias Tee por medio de líneas microstrip. La adaptación de línea coaxial a microstrip y de microstrip a coaxial que se realiza en los puertos 1 y 2 de los tres bloques mencionados, se hace por medio de conectores 2.4 mm modelo PE44221 (macho) [6] y PE44218 (hembra) [7] de Pasternack Enterprises. La señal continua ingresa al puerto 3 de los bloques Bias Tee por medio de un conector SMA PE4001 (hembra) [8] de Pasternack Enterprises, que hace la transformación a microstrip. En la figura 3.2 se pueden ver los conectores mencionados.

Dado que los transistores a medir, los cables coaxiales y el VNA tienen una impedancia de 50Ω , para evitar perdidas y reflexiones debidas a desadaptación de impedancia, se diseñan

todos los componentes del sistema de calibración en 50 Ω . Esto incluye el Bias Tee y los standards de la calibración TRL.



Figura 3.2: Conectores. (a) 2.4 mm macho. (b) 2.4 mm hembra. (c) SMA hembra.

3.2. Transistor a Utilizar

El sistema de caracterización esta diseñado para trabajar con una variedad de transistores HEMT, sin embargo, cada transistor debe ir montado en un bloque acorde a las dimensiones físicas del dispositivo. El sistema descrito en esta memoria fue diseñado para caracterizar el transistor pHEMT modelo EC2612 [9] marca UMS [10].

En la figura 3.3 se puede ver el esquema del transistor en cuestión y sus dimensiones físicas en μm . Se puede ver que Gate y Drain tienen un pad de conexión cada uno y que existen dos pads para source. Estos últimos están conectados a la metalización posterior del transistor, lo que permite conectarlos directamente a tierra.

3.3. Bias Tee

El Bias Tee se encarga de tomar la señal proveniente del VNA y mezclarla con el voltaje continuo proveniente de la fuente de polarización, de modo de poder entregar señal y polarización al transistor HEMT por el mismo canal, tal como operan estos dispositivos.

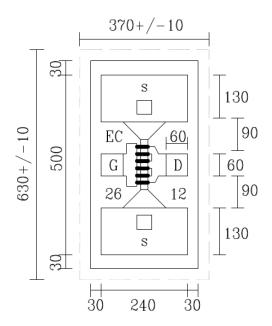


Figura 3.3: Esquema de transistor pHemt EC2612 con dimensiones físicas en μm .

Al mezclar la señal con la polarización, se debe cuidar que la señal no ingrese por el canal de polarización hacia la fuente, ni que el voltaje continuo ingrese por el canal de la señal hacia el VNA, ya que en ambos casos se pueden dañar estos dispositivos. Por esta razón, la mezcla de voltajes se debe hacer en este bloque y no directamente en el bloque del transistor. Se usará como convención que el puerto por el que ingresa la señal proveniente del VNA sera llamado puerto 1, el puerto 3 será por donde ingresa el voltaje de polarización y por el puerto 2 saldrán la señal y la polarización mezcladas. Además, el Bias Tee debe permitir que señales que ingresen por el puerto 2 puedan llegar al puerto 1, sin introducirse en el puerto 3.

La estructura básica del Bias Tee se compone de dos filtros, como se ve en la figura 3.4. Un filtro pasa altos se encarga de evitar que el voltaje continuo salga por el puerto 1. Un filtro pasa bajos se encarga de evitar que las señales de los puertos 1 y 2 salga por el puerto 3.

Es importante que en el filtro pasa altos el conductor esté cortado para garantizar el filtrado del voltaje continuo. En este caso, la señal de alta frecuencia debe pasar por el filtro

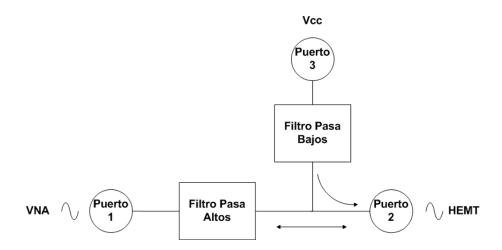


Figura 3.4: Diagrama de bloques del filtro Bias Tee.

Altura de substrato	$10 \ mil^{-1}$
Altura cada capa de cobre	$35 \ \mu m$
Constante dieléctrica ϵ_r	2.94
Factor de disipación TAN δ	0.0012

Cuadro 3.1: Parámetros substrato RT/duroid 6002.

por medio de un campo magnético o un campo eléctrico. De esta forma este filtro puede estar basado tanto en líneas acopladas como en la utilización de condensadores.

3.3.1. Diseño del Bias Tee

El Bias Tee estará fabricado en microstrip RT/duroid®6002 en cobre [11] de Rogers Corporation [12]. Las características del substrato se presentan en el cuadro 3.1.

Se realizaron simulaciones en Ansoft Designer para obtener un diseño funcional y luego se construyó un modelo en Ansoft HFSS para obtener una simulación más precisa del comportamiento del circuito. El diseño final obtenido en HFSS del Bias Tee se puede ver en la figura 3.5, donde el color naranjo representa al cobre, el verde al substrato duroid 6002, el

 $^{^1}mil$: unidad de medida de longitud del sistema imperial. Esta definida como milésima de pulgada. 1 mil equivale a 25.4 μm .

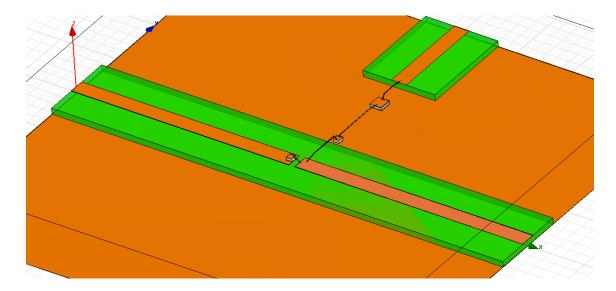


Figura 3.5: Renderización del modelo en HFSS del Bias Tee.

blanco al substrato de los condensadores y el amarillo a los bondings de oro. Estos últimos pueden ser vistos como líneas negras dependiendo de la escala de la renderización del modelo. A la izquierda está el puerto 1, que es el que irá conectado al VNA; a la derecha el puerto 2, encargado de llevar el bias y la señal alterna hacia el transistor; y arriba se encuentra el puerto 3, que va conectado a la fuente de voltaje continuo.

El ancho de las líneas microstrip es Calculado en Ansoft Designer para obtener impedancia de 50 Ω . Para esto se ingresa al programa las caracteristicas del substrato RT/duroid 6002 y la frecuencia a la que se quiere calcular la impedancia. Las líneas fueron calculadas para una frecuencia intermedia de 38 GHz.

Los filtros están diseñados en base a condensadores e inductancias lumped. Se dispone en el laboratorio de un pack de condensadores de microonda, por lo que se cuenta con valores discretos de capacitancia al diseñar el circuito. Los valores relevantes para el rango de frecuencia son 0.1pF, 0.4pF, 0.6pF, 1pF y 100 pF. Las inductancias se construyen con bondings de oro. Ya que HFSS sólo trabaja con los parámetros físicos del bonding, el valor de inductancia modelado sólo se puede calcular fuera del programa usando la aproximación de

Cap $[pF]$	Dimensiones $[mil]$	Altura [mm]	k
0.1	10×10	0.1	22.23
0.4	10×10	0.1	88.93
0.6	10×10	0.1	133.4
1	10×10	0.1	222.32
100	20×20	0.1	4376.56

Cuadro 3.2: Parámetros substrato RT/duroid 6002.

que el valor de inductancia será de 1 nH por cada mm de largo que tenga el bonding.

Los condensadores en HFSS son modelados construyendo dos placas paralelas separadas por un dieléctrico. Las dimensiones del modelo corresponden a las nominales de cada condensador real. El valor de capacitancia de cada condensador queda especificada por la constante de permitividad relativa k de su dieléctrico. Dado que esta constante no se encuentra en el datasheet, debe ser calculada según la formula 3.1. El cuadro 3.2 muestra los parámetros de los condensadores utilizados y la constante k calculada.

$$Capacitancia = \frac{k \times \epsilon_0 \times A}{d} [F] \tag{3.1}$$

Donde A es el área de las placas paralelas del condensador, d es la distancia que separa las placas, ambas medidas en unidades del Sistema Internacional y $\epsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12} \ F/m$.

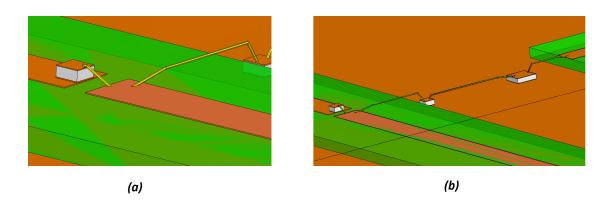


Figura 3.6: Renderización de los Filtros del Bias Tee en mayor detalle. (a) Filtro pasa altos. (b) Filtro pasa bajos.

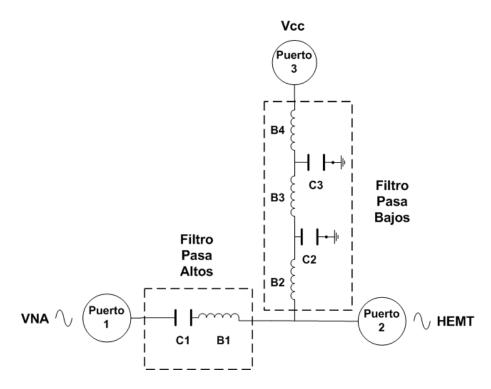


Figura 3.7: Diagrama circuital del Bias Tee.

El diagrama circuital en donde se presentan los elementos del Bias Tee se puede ver en la figura 3.7. En el diseño obtenido del filtro pasa altos la línea microstrip que sale del puerto 1 se conecta en serie a C_1 que esta montado sobre ella, como se ve en la figura 3.6 (a). El condensador se une a la línea microstrip que va al puerto 2 por medio del bonding de oro B_1 . el voltaje continuo del puerto 3 queda aislado del puerto 1 por el dieléctrico del condensador C_1 . Más aún el filtro L-C formado por C_1 y B_1 en serie, se encarga de filtrar señales alternas de baja frecuencia.

En el filtro pasa bajos los bondings B_2 , B_3 y B_4 se conectan en serie para unir el circuito principal con el puerto 3. Las uniones de estos bondings estan nontadas sobre los condensadores C_2 y C_3 que están en paralelo. Este filtro de bondings largos y condensadores en paralelo, tal como se ve en las figuras 3.7 y 3.6 (b), tiene una impedancia bastante mayor que el circuito principal. La señal que viaja del puerto 1 al 2, o viceversa, se encuentra con una alta impedancia en la rama que va hacia el puerto 3, por lo que no ingresa por esta rama. C_3

Curva	$C_1[pF]$	$C_1 k$	Color
S_{11}	0.1	22.23	Rojo
S_{11}	0.4	88.93	Azul
S_{11}	1	222.32	Rosado
S_{12}	0.1	22.23	Verde

Cuadro 3.3: Código de colores de parámetros S para las figuras 3.8, 3.9 y 3.10.

de mayor capacitancia se encarga de filtrar señales de baja frecuencia que puedan ingresar por la rama del puerto 3.

En el Bias Tee, el espacio que interrumpe transversalmente la línea que va del puerto 1 al puerto 2 es un factor determinante. El parámetro gap da cuenta de esta distancia en el modelo. El gap representa el parámetro más crítico del circuito, ya que define el largo del bonding B_1 , que es determinante en el filtro L-C del circuito pasa altos. Además, por sus pequeñas dimensiones, al rededor de los 10 mil, es la especificación más difícil de construir y la limitante física del diseño. Por esta razón se modeló B_1 parametrizado por el largo del gap. Luego mientras más pequeño el gap menor inductancia tendrá B_1 .

Los resultados obtenidos del modelo en HFSS para el filtro pasa altos se pueden ver a continuación. La figura 3.8 muestra los parámetros S del circuito para un gap de 6 mil, donde aparecen la transmisión S_{12} para un condensador de 0.1 pF (la que dio mejores resultados), y la reflexión S_{11} para valores de condensador de 0.1, 0.4 y 1 pF. En el modelo los condensadores están parametrizados por su constante de permitividad relativa k, la que está representada por el parámetro DiCap. Los gráficos de las figuras 3.9 y 3.10, muestran las mismas curvas, pero para valores de gap de 6 y 10 mil respectivamente. La nomenclatura para los gráficos en las figuras 3.8, 3.9 y 3.10, se muestra en el cuadro 3.3.

Se puede ver de los gráficos en las figuras 3.8, 3.9 y 3.10, que el valor de capacitancia más apropiado para C_1 independiente del largo de B_1 es 0.1 pF. Observando las curvas S_{11} para 0.1 pF, se tiene que para 10 mil en la figura 3.10 el filtro se centra en torno a los

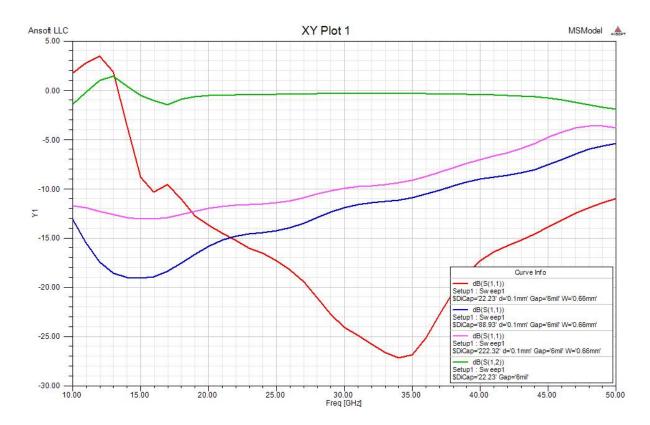


Figura 3.8: Simulación de Bias Tee en HFSS, con gap de 6 mil, para valore de C_1 de 0.1, 0.4 y 1 pF.

27GHz con el rango de 19-35 GHz bajo los -15dB. Para 8 mil en la figura 3.9 se centra en los 29 GHz con el rango de 19-38 GHz bajo los -15 dB. Para 6 mil en la figura 3.8 se centra en los 33 GHz con el rango de 22-44 GHz bajo los -15dB. Para los otros valores de capacitancia se obtienen reflexiones mayores, donde S_{11} no baja de los -15 dB entre los 25 y 50 GHz para ninguno de los tres gráficos. Dado que el transistor deberá funcionar para el rango de 30-50 GHz, el ideal es construir un Bias Tee que funcione en este rango para poder caracterizar el transistor en su frecuencia de operación. Como se ve en los gráficos, para centrar el filtro pasa altos a mayor frecuencia se tendría que disminuir el gap bajo los 6 mil.

Los parámetros críticos del modelo en HFSS son el B_1 , C_1 , B_2 y C_2 . Siendo el primero el más crítico, dado que no se dispone de un condensador de menor capacitancia que 0.1 pF, se debe acortar B_1 para lograr centrar el filtro pasa altos en la frecuencia deseada. Por motivos

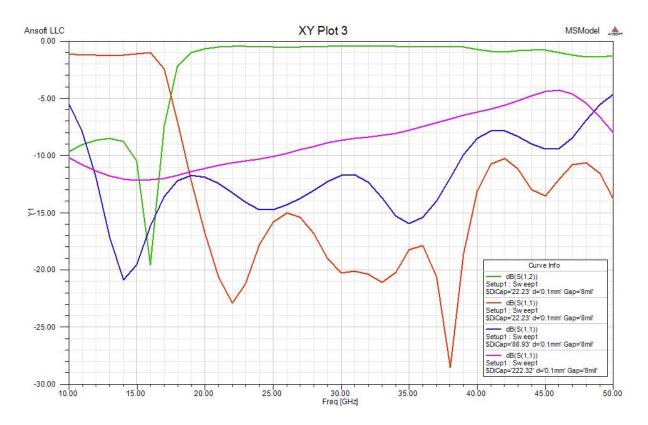


Figura 3.9: Simulación de Bias Tee en HFSS, con gap de 8 mil, para valore de C_1 de 0.1, 0.4 y 1 pF.

constructivos el gap no puede ser menor a 6 mil, siendo este último un valor ya bastante difícil de obtener, lo que acota el largo mínimo de B_1 a 0.76 mil.

3.3.2. Construcción de Componentes

Bloque de Montaje

El bloque metálico donde va montado el circuito del Bias Tee fue mecanizado en una fresadora de control manual en el taller mecánico del DAS. El material de construcción es duraluminio, que posee buena conductividad y resistencias mecánica.

El bloque forma una caja con un orificio de fondo cuadrado de 20 mm de lado. La profundidad del orificio, el grosor de la pared y la altura de la caja están diseñados ajustar a las

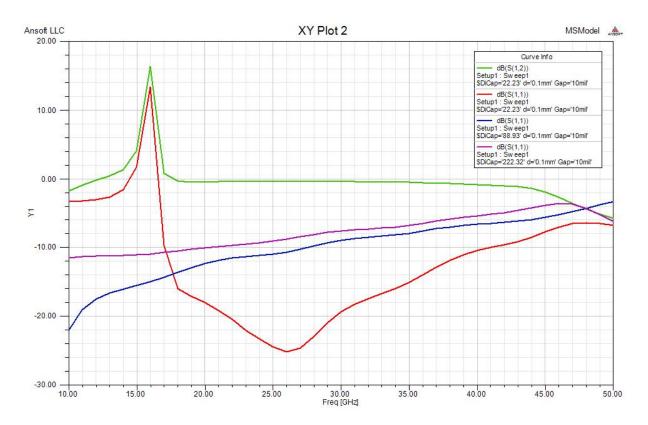


Figura 3.10: Simulación de Bias Tee en HFSS, con gap de 10 mil, para valore de C_1 de 0.1, 0.4 y 1 pF.

dimensiones de los conectores 2.4 mm y SMA. El grosor de la pared debe ser igual al largo del dieléctrico que cubre el pin de los conectores. La altura de la caja debe ser suficiente para poder montar los conectores en la pared. La profundidad del orificio debe ser tal que el pin de los conectores quede posado sobre la línea microstrip, para esto se debe considerar además de la altura de la línea microstrip, la altura extra que agrega el pegamento con que la línea va sujeta al bloque, que corresponde a cianoacrilato. La elección del pegamento será discutido más adelante. En la figura 3.11 se puede ver un diagrama que muestra el montaje de un conector 2.4 mm en la pared de la caja.

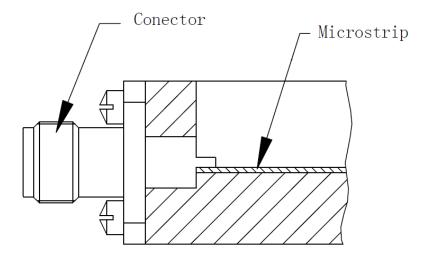


Figura 3.11: Diagrama de montaje de conector en pared del bloque de duraluminio.

Líneas Microstrip

La fabricación de las líneas microstrip constituye uno de los factores limitantes en la obtención del filtro diseñado. Las dimensiones arrojadas por por las simulaciones son difíciles de obtener sin una maquinaria especializada. El substrato escogido (TR/duroid 6002) se compone de dos placas de cobre muy delgadas que rodean una capa de dieléctrico, esto conforma una plancha. Para crear un circuito en esta plancha es necesario remover todo el cobre de la placa superior que no forme parte del circuito, de manera que quedara en la cara superior un circuito metálico dibujado sobre el substrato y en la cara inferior se tendrá una placa de cobre completa, la que corresponde al plano de tierra. Se puede extraer también todo el metal de la cara inferior si se sabe que el substrato ira pegado directamente sobre un conductor conectado a tierra.

Se estudiaron tres métodos de construcción para extraer el cobre sobre el dieléctrico:

■ Fresado en CNC

• Fresado en LPKF

Método fotoresistivo

Los primeros dos métodos consisten en pegar el substrato con cianoacrilato a una placa más rígida que va montada en la fresadora. La CNC es una fresadora con control numérico por computador de la que dispone el DAS. Tiene gran precisión y su satisfactorio desempeño fue comprobado en trabajos similares [13], pero su alto nivel de demanda y la existencia de otros métodos de construcción descartaron su utilización. La LPKF es una fresadora para crear circuitos impresos disponible en el DIE. Se realizaron pruebas de fabricación de circuitos microstrip que no dieron los resultados esperados. Si bien los cortes de la LPKF en el plano del circuito fueron lo suficientemente precisos para generar el circuito deseado, esta máquina esta diseñada para cortar substratos más gruesos, por lo que se presentaron dos problemas. En primer lugar la máquina se apoya sobre el circuito para realizar el fresado, por lo que al trabajar con RT/duroid 6002, raspa la delgada placa de cobre desgarrando los contornos ya generados. En segundo lugar los cortes producidos por la fresa son muy disparejos, por lo que era necesario realizar varias pasadas de fresado para lograr sacar una capa de cobre, donde cada vez se bajaba un delta la altura de la fresa. Esto resultó con sectores en el substrato con cortes muy poco profundos donde se logro sacar exitosamente el cobre, pero con otros donde la fresa había atravesado el substrato. Tener alturas de substrato distintas a la nominal cerca de las líneas implica que el campo eléctrico tendrá menos dieléctrico entre la línea y la tierra, lo que alterará el comportamiento esperado del circuito.

El circuito fue construido usando el método fotoresistivo. Éste consiste en imprimir el circuito requerido en una lamina transparente, luego aplicar la pintura fotosensible Positiv20 sobre la lamina de cobre del substrato donde irá impreso el circuito. Al aplicar luz ultravioleta sobre la cara pintada de cobre con la lamina transparente sobrepuesta, se debilitara la pintura expuesta a la luz (las áreas donde la transparencia no tenia impreso parte del circuito), luego se sumerge el substrato en soda caustica hasta que solo quede la pintura dibujando el circuito deseado. El substrato se sumerge finalmente en cloruro férrico donde

el cobre que no este protegido por la pintura será extraído del dieléctrico quedando solo el circuito impreso en la capa superior de cobre. En este último paso si no se quiere perder la capa de cobre inferior que hace de tierra, es necesario cubrirla con alguna protección contra el cloruro férrico, esmalte de uñas puede servir para esta tarea. Finalmente se limpia la pintura fotoresistiva y el esmalte si fue aplicado de las placas de cobre con acetona, obteniéndose el circuito deseado. Los pasos para realizar este método están detallados en el anexo A.1 de [13].



Figura 3.12: Fotografía de las líneas microstrip fabricadas.

Durante la fabricación, varias líneas fueron producidas en el mismo proceso sobre la misma placa de dieléctrico, luego el substrato fue guillotinado para separar las lineas en rectángulos independientes. La regla para los cortes es que a cada lado de la línea debe haber un área de substrato de ancho al menos 2.5 veces el ancho de la linea. Ésto asegura que el campo eléctrico se cierre a tierra a través del dieléctrico y no del aire en el borde de la rectángulo.

Las líneas obtenidas se muestran en la figura 3.12.

Se puede observar que este método no es del todo satisfactorio. De las líneas producidas se escogen las más adecuadas desechando al menos el doble de líneas defectuosas o menos aptas. Aun así las líneas escogidas muestran una deficiencia en el gap y sus bordes son disparejos. Siendo el primero el problema más relevante. Por esta razón, en la etapa de diseño no se fijo una distancia para el gap, si no que se estudio su comportamiento para un rango de valores de 6 a $10 \ mil$, donde se espera que este método pueda producir un gap entre estos valores.

3.3.3. Montaje del Bias Tee

Al perforar en el bloque metálico los forados para los conectores 2.4 mm la broca deja una cavidad en el suelo de la caja. Se detecto durante el montaje que las líneas se doblaban hacia abajo por la presión al contacto con los conectores en esta zona donde existe esta cavidad. Por esta razón, se decidió instalar en primer lugar una lamina de aluminio sobre el fondo de la caja, de forma de tapar estos resquicios. Esta lamina va afirmada por cuatro tornillos al bloque de duraluminio, esto además de sujetarla, asegura su conexión a tierra, ya que no se tiene certeza que la lamina quede bien apoyada al fondo de la caja. De ahora en adelante la referencia al fondo de la caja incluirá a la lamina montada sobre éste.

Elección Del Pegamento

En la elección del pegamento a utilizar se consideraron las siguientes opciones:

- Pintura de plata
- Cianoacrilato
- Pegamento Epóxico

La pintura de plata es un pegamento conductor de fraguado lento, lo que lo convierte en un buen candidato. Sin embargo durante pruebas de montaje de prototipos se observó que si bien esta pintura es de fácil de extraer con acetona, minúsculos residuos quedan adosados al substrato. Éstos al ser conductores pueden actuar como puntos de acumulación de carga que pueden interferir en el funcionamiento del circuito. Por esta razón fue descartada su utilización.

El cianocrilato es de fraguado rápido lo que dificulta su utilización, pero tiene la ventaja de su fácil extracción con acetona y que no deja residuos. Al no ser un material conductor se descarta su utilización en aplicaciones donde se requiera esta característica.

El pegamento epóxico es conductor y de fraguado lento. Es fácil de limpiar mientras no se haya cosido, lo que permite corregir errores de montaje. Una vez cosido resulta muy difícil de sacar. La experiencia mostró que después de 48 horas sumergido en cloroformo no se logro despegar un condensador de un bloque de duraluminio pegado con este método.

Se utilizará entonces cianoacrilato para pegar las líneas al fondo de la caja donde no se necesita un material conductor. Se estima que el efecto de agregar un segundo dielectrico (cianoacrilato) de mucho menor espesor entre el substrato y el bloque, no cambiara el desempeño del circuito. Los condensadores serán pegados con pegamento epóxico debido a la dificultad de su montaje, por lo que se necesita tiempo para montarlos correctamente. Además este pegamento asegurara el contacto eléctrico de la placa inferior del condensador con la superficie donde será pegado.

Líneas Microstrip

Las líneas que van del puerto 1 al 2 se pegaron con cianoacrilato al fondo de la caja intentando dejarlas alineadas entre los agujeros por donde ingresan los conectores 2.4 mm.

La línea que va al puerto 3 se pega de la misma manera, como solo se espera que pase un voltaje continuo por ella, la alineación con el pin del conector SMA no es importante, solo basta que el conector tenga una superficie de contacto adecuada sobre el cobre la línea.

El montaje de las líneas se puede ver en la figura 3.13.

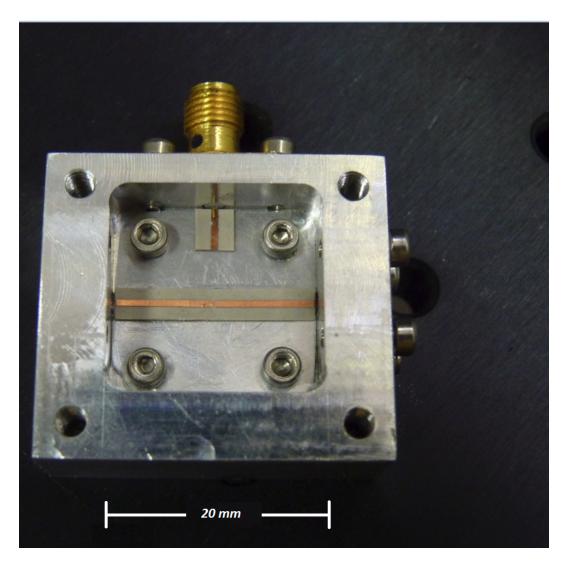


Figura 3.13: Fotografía de las líneas microstrip montadas sobre el bloque de duraluminio.

Dado que el bloque metálico fue fresado en una fresadora con control manual, resulta inevitable tener pequeñas imprecisiones. Éstas afectan por sobre todo la alineación de las

entradas de los conectores 2.4 mm por lo que resulta difícil alinear la línea principal con los pines de los conectores centrados en ella en ambos lados.

Condensadores

Los condensadores fueron pegados con pegamento epóxico. C_1 , es el más critico, debe ir lo más cercano al borde de la línea que sea posible de forma que el bonding B_1 tenga la mínima longitud al sobrepasar el gap. Se debe cuidar que su base quede totalmente sobre la línea para que al realizar el bonding no se rompa o desprenda la línea o el condensador. C_2 y C_3 van pegados sobre el fondo de la caja.

En la figura 3.14 se puede ver el montaje de líneas y condensadores.

Bondings de Oro

Con el resto de los elementos ya montados sobre el bloque metálico se procede a realizar los bondings. Para esto se utiliza la Bonding Machine modelo 4526 de la empresa Kuliche & Soffa [14] disponible en el laboratorio de Instrumentación Astronómica del DIE. Esta máquina permite realizar conexiones eléctricas entre objetos de pequeñas dimensiones por medio de un hilo de oro llamado bonding, por lo que esta máquina está dotada de gran precisión, un control automatizado y un microscopio para operarla. El detalle de su operación puede ser visto en [13].

3.4. Bloque del Transistor

Los componentes del bloque del transistor son similares a los de las Bias Tee pero sin la rama de polarización. Un par de conectores 2.4 mm en caras opuestas conectan a líneas microstrip que viajan hacia el dispositivo, un bonding se encarga de unir la línea proveniente

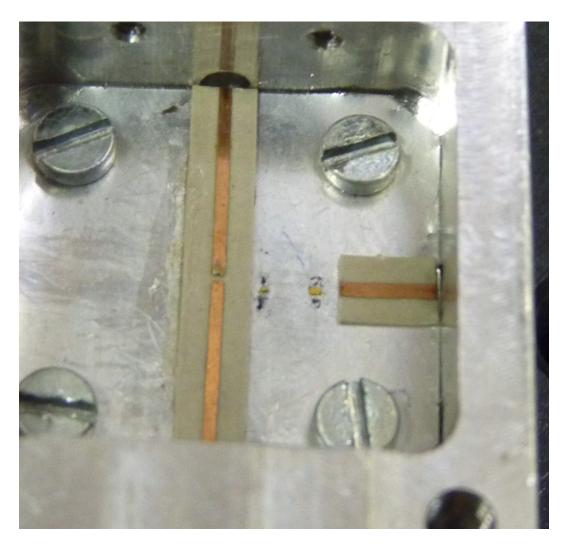


Figura 3.14: Fotografía de condensadores y líneas montados sobre el bloque de duraluminio.

del puerto 1 con el *pad Gate* del transistor, y otro se encarga de unir la línea proveniente del puerto 2 con el *pad Drain*. Los *pads Source* estan conectados a la cara inferior del transistor, que debe ir conectada a tierra.

Dado que se creo un bloque de conexiones rápidas para la calibración TRL, como se vera en la siguiente sección, se aprovechara este sistema para crear el bloque de montaje del transistor de manera compatible con este sistema.

Para el bloque del transistor y los bloques de los standards TRL el substrato microstrip

Altura de substrato	5 mil
Altura cada capa de cobre	$9 \mu m$
Constante dieléctrica ϵ_r	2.05
Factor de disipación TAN δ	0.00045

Cuadro 3.4: Parámetros substrato CuFlon.

utilizado es CuFlon de Polyflon Company [15], cuyas características se pueden ver en el cuadro 3.4.

El cambio de substrato se debe a que CuFlon presenta menores perdidas que RT/duroid 6002 y dado que por la precisión de los *standards* éstos requieren ser fabricados en la CNC, el menor grosor del substrato no representara un problema, como lo sería su fabricación por método fotoresistivo.

Las líneas que llevan la señal desde los puertos al transistor son de $50~\Omega$ y de un largo de 4~mm, este largo se consideró de manera que la onda se pueda adaptar de coaxial a microstrip antes de llegar al bonding del transistor. Éstas van pegadas con cianoacrilato al bloque metálico.

Entre las líneas se deja un espacio de 0.5 mm donde va montado el transistor que tiene 0.38 mm de ancho, lo que deja una distancia muy pequeña para que los bondings que unen el dispositivo a las líneas no tengan un elevado valor de inductancia. La cara inferior del transistor da la conexión a tierra, por lo que debe ser pegado con pegamento conductor. Como ya se menciono se utilizara pegamento epóxico, el que debe ser cuidadosamente aplicado para no formar cortocircuitos en el transistor, en las líneas o entre ambos.

3.5. Calibración TRL

3.5.1. Elección del Plano de Calibración

El diseño del sistema de calibración TRL es dependiente del lugar donde se sitúe el plano de calibración.

El objetivo de la calibración es descontar de la medición del dispositivo todos los efectos de los elementos conectados entre éste y el VNA. Los elementos descontados serán todos los que estén situados detrás de plano de calibración. Por este motivo el ideal es colocar el plano de calibración lo más cercano posible al dispositivo.

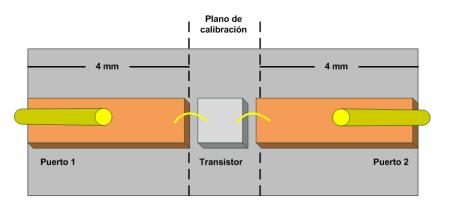


Figura 3.15: Diagrama que muestra el plano de calibración TRL en el bloque del transistor.

Los bondigs que unen el transistor a las líneas no pueden ser incluidos dentro de la calibración, por lo que se tendrá que hacer un *deembed* de estos posteriormente. De esta forma lo más cercano que se puede llevar el plano de calibración al transistor es hasta antes de estos bondings. De esta forma la calibración TRL estará descontando todos los cables coaxiales del sistema de medición, los Bias Tee y dentro del bloque del transistor, los conectores 2.4 mm y las líneas microstrip que llevan la señal al transistor.

El diagrama que muestra el plano de calibración en el bloque del transistor se puede ver en la figura 3.15, donde se puede notar que sólo el transistor y los bondings quedan fuera del plano de calibración.

3.5.2. Diseño y construcción de Standards

Con el plano de calibración ya escogido se puede diseñar el sistema de calibración TRL. Como se menciona en la sección 2.4.3 esta calibración esta formada por tres standards: Throu, Reflect y Line.

El Throu corresponde a unir los dos planos de calibración para que la señal pase directamente de uno a otro, como el plano de calibración esta a 4~mm de los puertos, se debe generar una línea de $50~\Omega$ de 8~mm de largo que conecte los dos puertos, así esta línea representa las líneas de 4~mm a cada lado conectadas directamente.

El Reflect sigue la misma lógica con dos líneas de 4 mm, pero estas están separadas por 2 mm de distancia, para que la onda se refleje a la altura del plano de calibración, regresando al VNA por el mismo puerto por el que ingreso. De esta forma el bloque tendrá que ser de 10 mm de ancho.

Line corresponde a una línea por donde la onda pasa del puerto 1 al 2, por lo que se debe construir una línea de largo mayor a 8 mm ya que esta distancia sólo cubre hasta el plano de calibración. Se escogió una línea de 3 mm por lo que el bloque deberá ser de 11 mm de ancho.

Debido al grado de precisión requerido en los *standards*, estas líneas fueron construidas en la CNC, . Para esto se pegó el substrato a un bloque metálico para darle rigidez, se montó en la CNC y se freso para formar las piezas requeridas. Luego, se despegan las líneas del bloque utilizando acetona. Se observó que la CNC no fue capaz de retirar completamente el cobre del substrato, por lo que se extrajo el cobre sobrante manualmente, aplicando cuidadosamente gotas de cloruro férrico sobre el metal sobrante.

3.5.3. Bloque de Calibración

Se diseño un sistema de montaje para realizar la calibración TRL donde los conectores 2.4 mm estarán conectados directamente al bloque de calibración, mientras que los bloques donde estará montado cada *standard* será acoplado al bloque principal logrando conectar de esta forma la línea del standard con los conectores.

Este sistema se puede ver en la figura 3.16, donde se puede ver uno de los bloques removibles acoplado y el sistema para conectar los conectores a los bloques moviles.

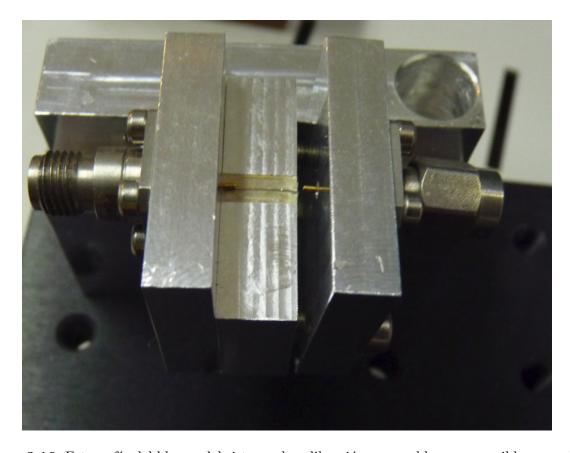


Figura 3.16: Fotografía del bloque del sistema de calibración con un bloque removible acomplado.

Los bloques independientes para montar líneas serán 5 en total: Throu, Reflect, Line,

Prueba y Transistor. Los primeros 3 corresponden a los standards de calibración, Prueba es una línea de distinto largo que Line, que se utiliza para comprobar que la calibración funciona correctamente, y Transistor corresponde al bloque donde irá montado el dispositivo a medir. Una de las ventajas de compatibilizar el bloque del transistor con el sistema de calibración es que al ser los bloques independientes más simples en diseño, al no incluir los conectores 2.4 mm, diseñar un nuevo bloque para caracterizar un nuevo transistor resulta más fácil y su construcción es más rápida.

3.5.4. Incorporación de la Calibración al VNA

Al realizar la calibración, el VNA abre un wizard donde el usuario le indica a la máquina que standard se esta midiendo, una vez medidos todos los standards, el VNA realizara los cálculos descritos en la sección 2.4.3 para descontar el efecto de los elementos que estén detrás del plano de calibración, con lo que se habrá efectuado la calibración. Pero para que el VNA reconozca los standards es necesario haberlos registrado previamente en la máquina y haber definido en ésta la calibración creada.

Los pasos para definir la calibración TRL descrita en el VNA son los siguientes:

- 1. Desplegar el menú Response, luego desplegar el menú Cal, de aquí el menú More y finalmente se aprieta Cal Kit.
- 2. Ésto abre la ventana de calibraciones. Aquí se aprieta *Insert New*, lo que despliega la ventana *Edit Kit*. Dentro de esta ventana en la sección *Identification* se le da el nombre y la descripcion a la calibración. En particular la calibración descrita se llama *QTRLMicrostrip*.
- 3. En la misma venta *Edit Kit* en la seccón *Connectors* a apreta en *Add or Edit*, con lo que se ingresa a la ventana *Add or Edit Connectors*, donde se definen los conectores,

dándoles nombre, frecuencia de operación entre 26 y 45 GHz, $Z_0 = 50$, y en media se escoge coaxial. Luego se cierra esta ventana.

- 4. En la parte inferior de la ventana $Edit\ Kit$, se presiona Add, y en la ventana desplegable se escoge $THRU\ y\ Ok$, luego se repite dos veces la operación anterior para escoger nuevamente $THRU\ y$ luego OPEN. Esto agregara estos tres standards a la lista.
- 5. Luego se procede a editar estos standards.

Se presiona sobre un THRU y luego se aprieta en Edit, esto abre la ventana Thru/Line/Adapter. Aquí se le cambia el nombre al standard por Line, se definen las frecuencias entre 26 y 45 GHz, Delay = 10, Loss = 0 y $Z_0 = 50$, y se cierra esta ventana.

Se presiona sobre el THRU restante, y se presiona Edit, volviendo a ingresar en la ventana Thru/Line/Adapter, se nombra el standard como THRU, se definen las frecuencias entre 26 y 45 GHz, Delay = 0, Loss = 0 y $Z_0 = 50$, y se cierra esta ventana.

Se presiona sobre OPEN, y se presiona Edit, con lo que se ingresa a la ventana Opens, se nombra el standard como OPEN, se definen las frecuencias entre 26 y 45 GHz, $C_0 = 1$, $C_1 = 0$, $C_2 = 0$, $C_3 = 0$, Delay = 0, Loss = 0 y $Z_0 = 50$, y se cierra esta ventana.

- 6. Una vez definidos los standards, pueden ser asignados a la calibración. Para esto en la sección Class Assignment, se escoge TRL en el menu desplegable, y se aprieta el botón, con lo que se ingresa a la ventana Modify TRL Calibration Class Assignment. Dentro de esta ventana se chequea en TRL THRU, LINE Z₀ y THRU Standard. Finalmente en la sección baja de esta ventana se presiona sobre THRU, y se presiona en la flecha hacia la derecha, lo que mueve el standard THRU de la lista unselected a la lista selected. Se cierra la ventana Modify TRL Calibration Class Assignment.
- 7. Con esto la calibración esta definida en el VNA, y puede ser accesada como cualquier

3.6. Protocolo de Pruebas y Procesamiento de Datos

3.6.1. Protocolo de Pruebas

Las pruebas se realizan montando el sistema de pruebas como se ve en la figura 3.1 de la sección 3.1. Antes de realizar las mediciones se efectúa la calibración TRL. Para esto se reemplaza el bloque del transistor por los distintos standards de la calibración y se mide con el VNA utilizando el wizard de calibración TRL custom. Una vez terminado este procedimiento se puede comprobar que la calibración estuvo bien efectuada colocando el bloque que contiene la línea de prueba. Donde se debería obtener al medir con el VNA reflexiones bajo los -30 dB, y transmisiones muy cercanas a 0 dB.

Se deben realizar tantas pruebas como puntos de operación se quieran conocer para el transistor. Las variables a medir en todas las pruebas son siempre los parámetros S del circuito de pruebas, el que estará formado después de la calibración por el transistor y las dos inductancias en serie que generan los bondings.

La primera prueba con la que se determinan los parámetros extrínsecos del transistor se realiza a $V_{gs} = 0$, por lo que se regula la fuente de voltaje continuo que ingresa al Bias Tee 1 para que entregue 0 V, y de esta forma entregar al Gate 0 V. Esta prueba solo se realiza una vez por transistor ya que no depende de la polarización del dispositivo.

El segundo set de pruebas corresponde a variar el voltaje continuo que ingresa al Bias Tee 1, que significa variar el punto de operación del transistor variando el voltaje V_{gs} . Con esto se tendrán tantas matrices S como voltajes se apliquen al transistor.

En todas pruebas efectuadas se deben medir los parámetros S para las mismas frecuencias, tomando el mismo numero de puntos. De esta forma al procesar los datos se podrá trabajar

con cada set de medición en las mismas frecuencias.

3.6.2. Procesamiento de Datos

Una vez obtenidas las matrices S para cada punto de operación deseado del transistor, más la matriz S del transistor a $V_{gs}=0$, se procede a procesar estos datos para obtener los parámetros del circuito equivalente del dispositivo. Para esto se realiza el método de caracterización descrito en la sección 2.3, implementado en el programa Matlab de la empresa MathWorks [16]. Matlab posee una librería especializada para trabajar con parámetros S capaz de abrir un archivo de extensión $.s2p^2$ e importar los parámetros S cargándolos en variables especializadas para tratar con este tipo de datos.

El algoritmo fue implementado en tres archivos, el primero consiste en el programa principal HEMTECP, que se encarga de llamar a un segundo archivo que contiene la función EXTR que se encarga de calcular los parámetros extrínsecos del transistor medido abriendo el archivo que contiene las mediciones a $V_{gs} = 0$, y los retorna al programa principal. Luego HEMTECP se llama a un segundo programa INTR que se encarga de calcular los parámetros intrínsecos del transistor para un cierto punto de operación y lo retorna al programa principal. HEMTECP llamara tantas veces a INTR como puntos de operación hayan sido medidos en el transistor (valor que debe ser especificado en el código de HEMTECP). Los archivos con las mediciones para obtener los parámetros intrínsecos se deben llamar de la misma forma y diferenciarse por terminar con (n), donde n es el numero de medición, de esta forma el programa abrirá todos los archivos, calculando todos los parámetros para cada punto de operación. El código del programa descrito se encuentra en la sección A de Anexos.

 $^{^2}$ Extensión .s2p: archivo de texto ASCII que contiene los parámetros S de un circuito de dos puertos. Llamado archivo Touchstone, se utiliza tanto en programas de simulación como en equipos de medición.

Capítulo 4

Resultados y Análisis

4.1. Bias Tee

El VNA es solo capaz de medir redes de dos puertos, por lo tanto para obtener el funcionamiento completo del dispositivo se deberán realizar tres sets de mediciones. Primero se medirá conectando los puertos 1 y 2 del Bias Tee al VNA, luego 1 y 3, y finalmente los puertos 2 y 3. La primera medición es la más relevante ya que por las limitaciones físicas en la construcción del gap, se pueden tener en esta conexión los peores resultados. Lo anterior enumerando los puertos del Bias Tee de la misma manera que en la sección 3.4, como aparece en la figura 3.4.

La medición se realiza conectando el puerto 1 del VNA al puerto 1 del Bias Tee y el puerto 2 del VNA al 2 del Bias Tee. El VNA actualmente se encuentra con algunos problemas técnicos, por lo que solo puede operar hasta los 45 GHz. Los parámetros S de la configuración descrita se puede ver en el gráfico de la figura 4.1. Los resultados observados muestran una transmisión inferior a los -5 dB en la mayor parte del rango de interés (20 a 45 GHz), y una reflexión que supera la transmisión en el rango de 37 a 45 GHz.

Estos resultados no son los esperables tomando en cuenta las simulaciones. Se cree que el problema no esta en el circuito del Bias Tee construido, si no que en algún otro elemento del bloque de montaje. Se realizaron varias pruebas para intentar identificar la causa de estas

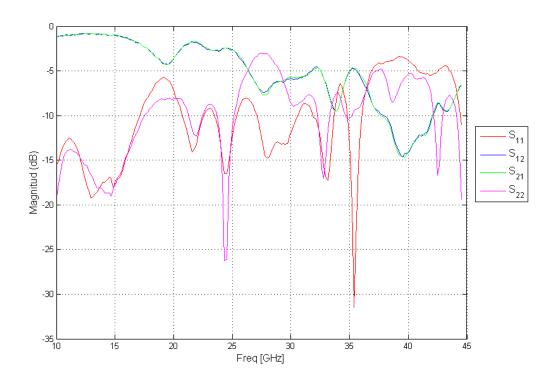


Figura 4.1: Gráfico de parámetros S del Bias Tee. Conectores 2.4 mm.

medidas, como encerrar el circuito en un tunel metálico para disminuir las reflexiones y resonancias con la caja de montaje, usar el bloque con y sin tapa, y remover el suelo de aluminio incorporado, pero se obtuvieron resultados semejantes. También se considero problemas en la fabricación de las líneas en el sustrato RT/duroid 6002, o que el substrato mismo no fuera el adecuado, pero en la construcción del bloque de calibración se trabajo con substrato distinto obteniéndose los mismos resultados. Esto llevo a conjeturar que los conectores 2.4 mm son la causa del problema. El análisis de estos conectores se realiza más adelante en la sección 4.3.

Para descartar que el problema de las mediciones esta en el diseño o construcción del Bias Tee se monto en un bloque idéntico una línea microstrip de 50 Ω , y se midió con el VNA, utilizando los conectores 2.4 mm. El gráfico con los parámetros S de la línea medida se pueden ver en la figura 4.2. Si bien se observa una ventana entre los 26 y 34 GHz donde la reflexión esta por debajo de los -10 dB y en general las reflexiones son más bajas que en

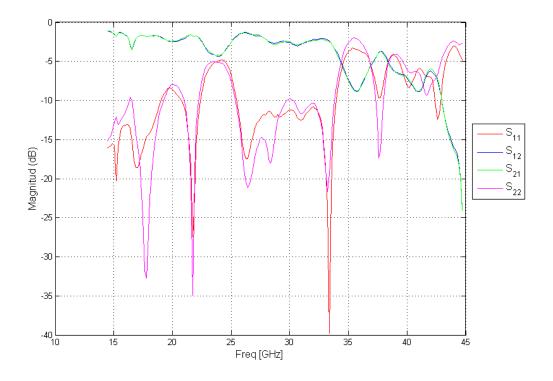


Figura 4.2: Gráfico de parámetros S de línea de 50 Ω . Conectores 2.4 mm.

el circuito de Bias Tee, las mediciones no corresponden a lo que se espera al medir una línea de igual impedancia que el sistema, donde se deberían obtener reflexiones menores a -10 dB de 10 a 44 GHz.

De esta forma los resultados obtenidos no reflejan el comportamiento del circuito construido, y por lo tanto no se realizo el resto de mediciones para comprobar el funcionamiento del Bias Tee, esperando encontrar una solución a este problema.

4.2. Calibración TRL

Las pruebas efectuadas sobre el bloque de calibración se realizaron conectándolo directamente al VNA, con lo que la calibración estará descontando solo los cables coaxiales del

VNA, los dos conectores 2.4 mm y la línea microstrip entre los conectores y el plano de calibración. Al realizar la calibración, el último standard utilizado fue el THRU, con lo que sera lo primero en ser medido una vez la calibración este finalizada. En la figura 4.4 se puede ver los parámetros S vs frecuencia del THRU con la calibración operando. Como punto de comparación se incluye en la figura 4.3 la medición efectuada al THRU con calibración estándar, esta ademas ayudara en la discusión sobre los conectores 2.4 mm.

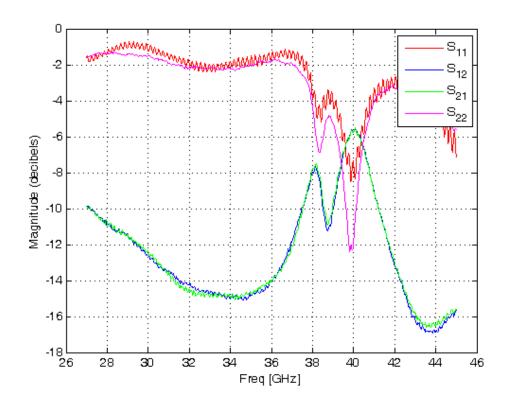


Figura 4.3: Gráfico de parámetros S del $standard\ Thru$ bajo calibración estándar.

Se puede notar en el gráfico de la figura 4.3 que las reflexiones son más altas que la transmisión, con lo que se obtuvieron aun peores resultados midiendo un línea de 50 Ω en CuFlon que en RT/duroid 6002 (figura 4.2).

Se puede apreciar del gráfico de la figura 4.4 que la calibración logra anular el mal desem-

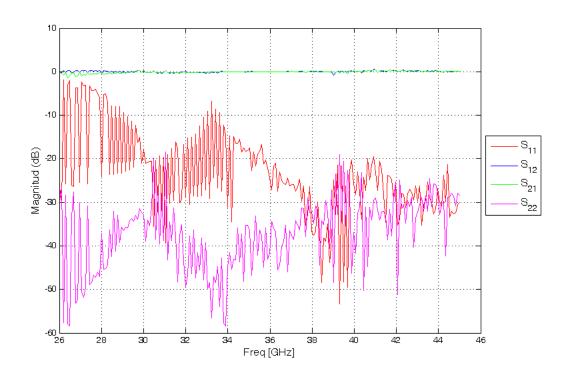


Figura 4.4: Gráfico de parámetros S del $standard\ Thru$ tras la calibración TRL.

peño de los conectores que se aprecia claramente en el gráfico de la figura 4.3, obteniéndose transmisiones cercanas a los 0 dB y reflexiones en torno a los -20 dB. Con este resultado se tiene que el sistema es apto para poder medir el transistor y caracterizarlo, pero un problema fue encontrado al realizar pruebas adicionales. Al desacoplar el conector del puerto 2 del standard Thru en el bloque de calibración y luego volverlo a conectar, sin cambiar nada más de la configuración en la prueba, se encontró que los parámetros S del standard cambiaron totalmente en comparación a lo que se tenia en la figura 4.4. Los nuevos parámetros se pueden ver en el gráfico de la figura 4.5, donde se puede ver que la transmisión sobrepasa los -5 dB solo en el rango de 42 a 45 GHz y que la reflexión no solo es más alta que en la medición anterior si no que ademas sobrepasa los 0 dB.

Estos últimos resultados se pueden asociar a un error numérico. S_{11} en el gráfico de la figura 4.5 llegan hasta los 20 dB, medida físicamente imposible en una red pasiva, que solo

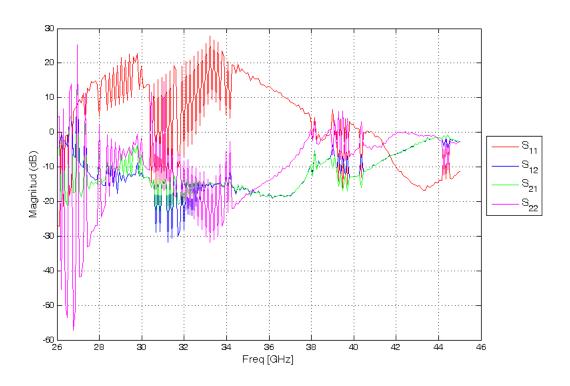


Figura 4.5: Gráfico de parámetros S del $standard\ Thru$ tras la calibración TRL, al reconectar el puerto 2.

se puede explicar en que el VNA al hacer la corrección numérica a los valores medidos para aplicar el efecto de la calibración, el error numérico se expande alterando las mediciones a valores que no representan el circuito medido. El echo de obtener resultados distintos al medir el mismo circuito, bajo la misma calibración, en el mismo espacio de tiempo, y con la sola diferencia de haber reconectado un puerto, implica que la calibración es extremadamente sensible a la posición del pin del conector 2.4 mm sobre la línea a medir, más de lo que es esta posición al medir sin esta calibración TRL. Esto implica que el crecimiento del error numérico hace la calibración altamente inestable, y por lo tanto inefectiva para realizar la caracterización de transistores, ya que al conectar el bloque con el transistor en el sistema de medición la calibración se perderá.

Este problema se asocia a los conectores 2.4 mm, ya que al obtenerse con estos altas reflexiones y bajas transmisiones como se ve en la sección 4.1, la calibración no obtiene la

precisión suficiente para descontar estos efectos. De esta forma se espera que resolviendo el problema de los conectores, el sistema de calibración tendrá un funcionamiento adecuado.

4.3. Análisis de conectores 2.4 mm

En los resultados arrojados tanto por las mediciones del Bias Tee como por el sistema de calibración se encontró un alto nivel de reflexión, lo que sugiere un elemento común en ambos bloques de montaje. El diseño del filtro Bias Tee queda descartado de momento como error, ya que al medir líneas de $50~\Omega$ se tiene el mismo resultado, en ambos bloques. EL método de fabricación y la precisión de las líneas microstrip queda descartado ya que se fabricaron con procesos diferentes, para distintos substratos, y en el caso de los standards de calibración fueron fabricados en la CNC donde se obtienen formas más precisas que con el método de pintura fotoresistiva. Los bloques metálicos donde van montados los circuitos son diferentes también para ambos montajes. Esto deja los conectores $2.4~\mathrm{mm}$ como el principal elemento en común.

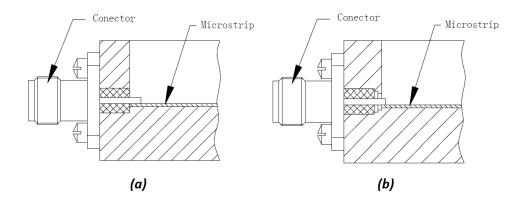


Figura 4.6: Diagrama de montaje de conectores 2.4 mm. (a) montaje simple. (b) montaje de adaptación.

Se busco información relativa al montaje de los conectores en la pagina del fabricante [17], pero no se encontró información relevante. En cambio en la pagina de Allwin Technology [18], otro fabricante de conectores, se describen varias formas de montaje. En particular,

se encontró el llamado montaje de adaptación, en el que se adaptar la llegada del conector a la línea microstrip por medio de variaciones en el radio del agujero en la pared del bloque metálico por donde atraviesa el conector, de forma que el dieléctrico que rodea al pin no llegue hasta el final del túnel. De esta forma, la sección del pin entre el dieléctrico y la punta que sobresale del agujero, estará rodeado por aire, y el radio del túnel de esta sección se estrechara escalonadamente. En la figura 4.6~a) se puede ver el montaje utilizado en el presente trabajo, mientras que en la figura 4.6~b) se puede ver el montaje de adaptación sugerido por Allwin.

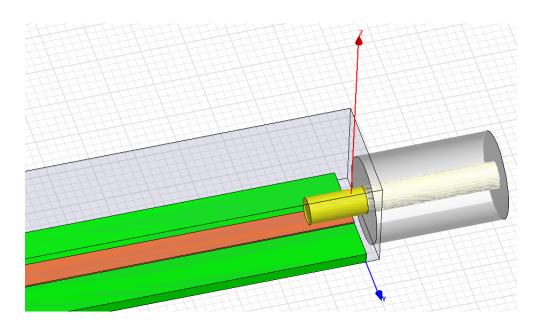


Figura 4.7: Renderización del modelo en HFSS del conector 2.4 mm en configuración simple.

Se crearon dos modelos en HFSS para simular el comportamiento de los conectores. El primer modelo consiste en un conector acoplado a una línea microstrip RT/duroid 6002, en montaje simple, donde un puerto esta en el conector, y el otro al final de la línea. El segundo modelo corresponde al mismo conector y la misma línea pero en montaje de adaptación como el de la figura $4.6\ b$). El datasheet [6] se indica que el substrato del conector esta formado por oxido de polifenileno, dado que no indican sus propiedades eléctricas, se realizaron simulaciones donde se determino que el substrato debe tener propiedades parecidas al teflón, por lo que los modelos mencionados se realizaron utilizando este material (de constante dieléctrica

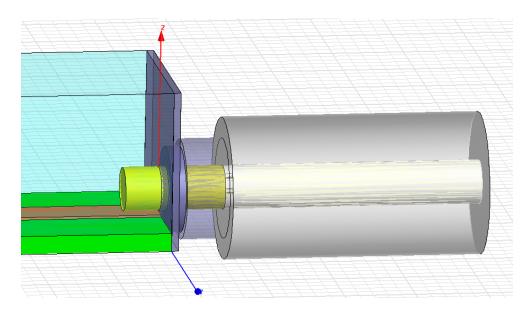


Figura 4.8: Renderización del modelo en HFSS del conector 2.4 mm en configuración de adaptación.

igual a 2.98), y oro para el conductor. En la figura 4.7 se puede ver la renderización del modelo en montaje simple, mientras que en la figura 4.8 se ve el modelo en configuración de adaptación. Para este último modelo se realizaron simulaciones para encontrar las dimensiones que lograban la mejor adaptación.

Los gráficos de las figuras 4.9 y 4.10 muestran los parámetros S del circuito línea-conector para el montaje simple y el montaje de adaptación respectivamente. Se puede observar en la figura 4.9 que la transmisión en la simulación es mucho más alta que en el sistema real, siendo superior a -1 dB en prácticamente todo el ancho de banda, mientra que en el real (figura 4.2) se midieron transmisiones inferiores a -2.5 dB hasta los 33 GHz, que luego están por bajo los -5 dB para frecuencias mayores. Esto indica que la simulación no es capaz de describir todos los fenómenos relevantes que se tienen en el sistema construido. De todas formas la simulación muestra que el circuito línea-conector tiene alta transmisión y baja reflexión de 10 a 30 GHz donde se tienen reflexiones menores a -15 dB, pero para frecuencias mayores la reflexión va aumentando hasta llegar a los -10 dB a 45 GHz y a -7 dB a 50 GHz, lo que implica un reflexión menor a -1 dB a esta última frecuencia. Esto puede dar explicación a

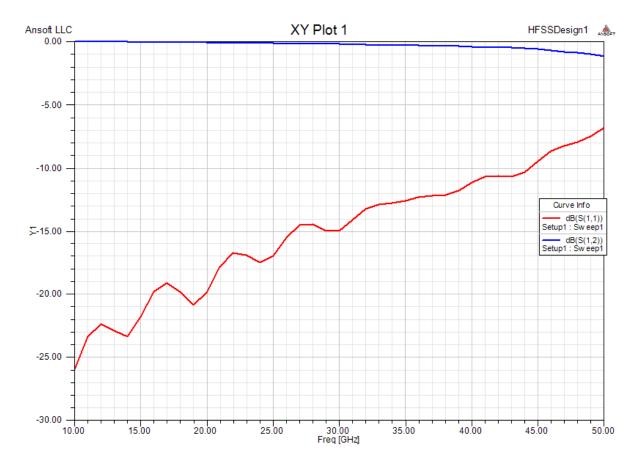


Figura 4.9: Gráfico de parámetros S de la simulación del conector 2.4 mm en configuración simple.

las altas reflexiones y bajas transmisiones encontradas al medir el sistema real a frecuencia superiores a 33~GHz.

Al observar el gráfico de la figura 4.10, se puede ver que la adaptación realizada entre la línea y el conector mejora considerablemente el desempeño del circuito, donde se obtienen una reflexión inferior a -20 dB y una transmisión superior a los -0.5 dB en todo el ancho de banda de 20 a 50 GHz, lo que implica reflexiones un 30 % más bajas en promedio en comparacion con la simulacion del montaje simple. Se observa en particular que el montaje adaptado tiene mejor funcionamiento a freceuncias altas en comparacion al simple, mientras que empeora ligeramente para las frecuencias más bajas, pero en general tiene un comportamiento más robusto en todo el ancho de banda.

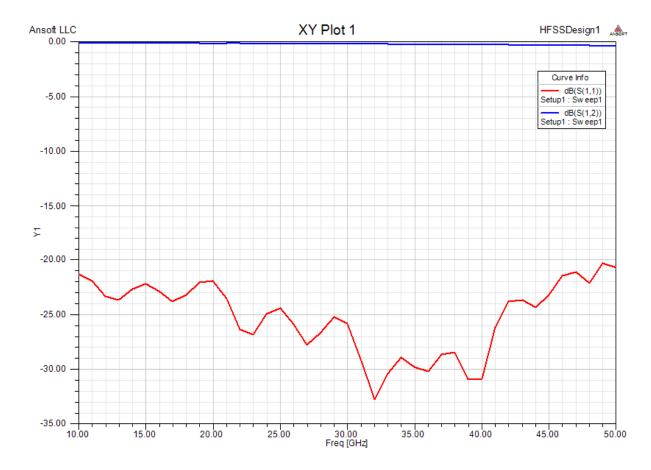


Figura 4.10: Gráfico de parámetros S de la simulación del conector 2.4 mm en configuración de adaptación.

Estos resultados indican que, al menos a nivel de simulación, se logra una mejor adaptación de impedancia del conector utilizando el montaje con adaptación. El siguiente paso es construir un bloque prototipo para probar el montaje sugerido, donde se espera un mejor desempeño en comparación con el montaje simple que se utiliza actualmente. Debido a la precisión requerida, la fabricación de este bloque requerirá la utilización de la CNC, dado el gran nivel de demanda de esta máquina, la construcción de este prototipo quedará a discreción del Grupo de Instrumentación Astronómica, y podría tomar algún tiempo antes de poder ser realizado, por lo que esta etapa queda fuera del presente trabajo de memoria.

Se realizaron más simulaciones para observar el comportamiento del circuito línea-conector

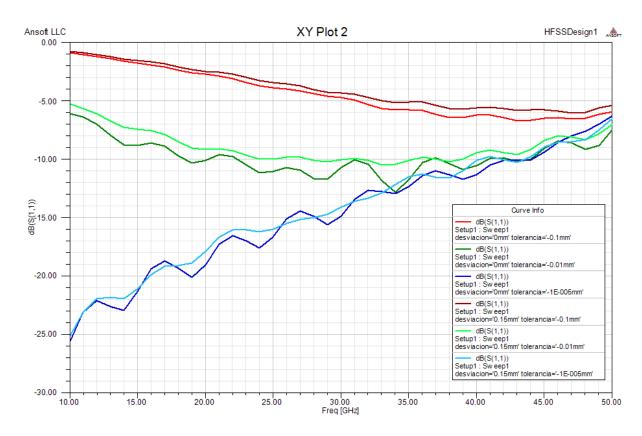


Figura 4.11: Gráfico de parámetros S_{11} de la simulación del conector 2.4 mm en configuración simple, ante variaciones de su alineamiento vertical y horizontal con respecto a la línea.

ante errores de precisión detectados en el montaje real. Específicamente se probo como afecta que el conector esté separado verticalmente de la línea, y el efecto de la alineación horizontal entre el conector y el centro de la linea. En los modelos en HFSS el parámetro tolerancia indica cuanto está separado el extremo inferior del pin respecto a la línea microstrip, cuando este valor es cercano a cero (igual a cero genera un error numérico en la simulación) significa que se están tocando, mientras que a medida que este valor crece negativamente, el pin se estará elevando por sobre la línea. El parámetro desviacion da cuenta de cuanto esta desalineado el centro del pin con respecto al centro de la línea, valores positivos implica que el pin mueve en sentido positivo a lo largo del eje Y del sistema de referencia de las figuras 4.7 y 4.8 representado por un vector azul.

El gráfico de la figura 4.11 muestra los parámetros S_{11} del modelo de montaje simple

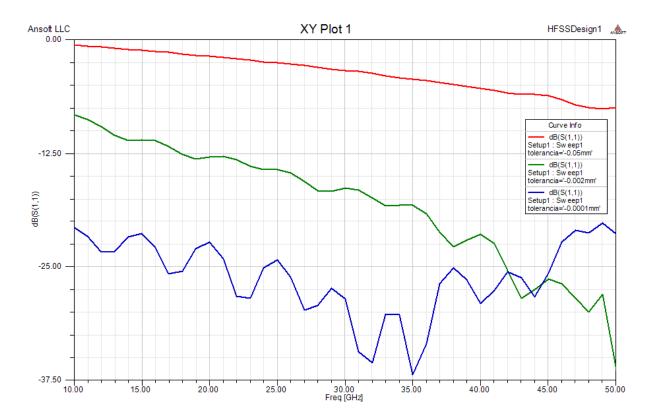


Figura 4.12: Gráfico de parámetros S_{11} de la simulación del conector 2.4 mm en configuración de adaptación, ante variaciones de su alineamiento vertical con respecto a la línea.

para distintos valores de desviacion y tolerancia. Aquí se puede ver que la elevación del pin es preponderante en el nivel de reflexión, donde para una elevación de $0.01 \ mm$ se obtienen reflexiones en torno a los -10 dB, 5 dB en promedio por sobre la reflexión para una tolerancia cercana a cero. Mientras que para una elevación de $0.1 \ mm$ se tienen reflexiones en torno a los -5 dB. Se puede ver que la elevación del pin tiene mayores aumentos de reflexión mientras más baja sea la frecuencia. Este efecto podría estar afectando el montaje real donde el problema de montaje es más complejo con el pin del conector conectado en diagonal hacia la línea.

El este gráfico se ve que el efecto de la alineación horizontal es mucho menor, donde para cada valor de elevación se simularon dos posiciones horizontales del conector, una en el centro, y otra a $0.15 \ mm$ del centro de la línea. La reflexión no cambia en más de un decibel entre ambas posiciones.

Se simulo también como afecta la elevación al modelo con adaptación para conocer su comportamiento ante posibles errores de conexión y observar si es más robusto ante este problema. En el gráfico de la figura 4.12 se pude ver como cambia el parámetro S_{11} para valores de elevación de $0,0001 \approx 0,\,0.002$ y 0.05 mm, donde se puede apreciar que para 0.002 la reflexión aumenta en promedio de -26 a -13 dB aproximadamente para frecuencias inferiores a 38 GHz, pero para frecuencias mayores la reflexión a 0.002 mm de elevación es más baja que en el caso de elevación cero. Para una elevación de 0.05 mm se ve que la reflexión es superior a -7.5 dB en todo el ancho de banda. Se observa además que a diferencia de las simulaciones para el modelo de conexión simple, el efecto de la elevación no empeora la reflexión para frecuencias bajas.

Capítulo 5

Conclusiones

El objetivo del presente trabajo es diseñar, fabricar y probar un sistema de calibración de transistores HEMT. El sistema de calibración esta compuesto de cuatro elementos principales, el VNA que se utilizara para medir los transistores, el Bias Tee que mezcla la señal y la polarización que ingresaran al transistor, el bloque de calibración TRL necesario para descontar de la medición del transistor el efecto del resto de los elementos des sistema de caracterización, y un programa computacional que calcula a partir de las mediciones, los parámetros del transistor. Se utilizara el sistema de calibración como bloque donde va montado el transistor.

Las simulaciones arrojaron que el circuito Bias Tee diseñado tendría reflexiones menores a los -10 dB en gran parte del ancho de banda (18 a 40 GHz) si se lograba la precisión de construcción adecuada ($gap < 10 \ mil$). Al medir el circuito construido se encontró que si bien la precisión lograda en microstrip era cercana a la esperada, los niveles de reflexión medidos fueron mucho más altos de lo esperado, superiores a -10 dB de 17 a 45 GHz. Para comprobar si el problema es el filtro diseñado o algún problema en el método de montaje, se probo construir, montar y medir una línea de 50 Ω , donde se encontraron reflexiones mayores a -10 dB en gran parte del ancho de banda. Ésto implica que el problema esta en el montaje.

También se tuvieron problemas en el sistema de calibración TRL construido. En primer

lugar se observo que si bien éste y el Bias Tee estaban construidos con distintos substratos, y más aun el sistema de calibración fue construido utilizando la CNC, ambos bloques al ser medidos con el VNA mostraron altos niveles de reflexión y baja transmisión. En segundo lugar se observo que la calibración TRL construida disminuía considerablemente el efecto de los demás componentes de la medición del elemento que se encontraba entre los planos de calibración (el standard THRU), era muy inestable y ante cualquier variación del montaje, la calibración dejaba de funcionar, observándose en el VNA curvas físicamente imposibles. Esto fue atribuido a un error numérico causado por el mal funcionamiento detectado del bloque, debido a las malas transmisiones del sistema.

Se encontró que el elemento común entre el montaje del Bias Tee y el montaje de la calibración lo constituían los conectores 2.4 mm. De esta forma se procedió a analizar estos conectores creando un modelo en HFSS y simulando su comportamiento al estar conectado a una linea microstrip. Se encontró ademas que existía un método alternativo de montaje del conector llamado montaje de adaptación, por lo que también fue modelado en HFSS en busca de una explicación al problema. Las simulaciones arrojaron que el conector en montaje simple si bien tenía reflexiones más bajas que las mediciones del sistema real, las reflexiones del modelo aumentaban a alta frecuencia, tal como ocurría en el sistema real. El modelo del montaje de adaptación revelo tener un mejor comportamiento que el de montaje simple, con una reflexión bajo los $-20 \ dB$ en todo el ancho de banda, y ser más robusto a altas frecuencias.

Se realizaron pruebas de sensibilidad en ambos modelos, para comprobar como afecta la posición del pin del conector respecto a la línea microstrip. Se observo que la alineación lateral no era tan relevante, lo que indica que para los montajes reales este no debería ser un factor preponderante. Por otro lado se observo que ambos modelos modelos eran sensibles a la elevación del pin sobre la línea, esto es importante ya que de momento los sistemas de montaje utilizados no garantizan que el pin que ajustado con buena precisión sobre la línea, en general queda un poco sobre y en diagonal, o queda presionando fuertemente la línea al

punto de deformarla.

El trabajo realizado en esta memoria se ve interrumpido por razones de tiempo, ya que construir el prototipo del montaje de adaptación requerirá la utilización de la CNC, máquina de disponibilidad reducida debido a la alta demanda que genera. Con esto, de los objetivos planteados, solo se logro cumplir con las etapas de diseño y construcción. Dado que los módulos finales no funcionaron de forma correcta, no se puedo caracterizar un transistor de forma exitosa.

Queda propuesto realizar más simulaciones del montaje de los conectores 2.4 mm, modelando el pin deformando la línea, el pin incidiendo de manera diagonal a la línea, y el pin unido por soldadura a la línea a distintas alturas. Se sugiere como continuación de este trabajo, construir un prototipo de montaje de conector 2.4 mm de tipo adaptación, revisar el resto de técnicas de montaje y buscar maneras de aumentar la precisión de éstas, como puede ser la utilización de un micromanipulador de manera de tener mayor precisión al colocar las líneas microstrip, condensadores, transistores u otros elementos de tamaños milimétricos, que requieran ser insertados con en los bloques de montaje. Ademas se sugiere revisar el substrato utilizado en el sistema de calibración, ya que CuFlon se deforma fácilmente ante la presión de los conectores, y ademas como el bloque de calibración es un sistema móvil, las líneas microstrip de éste se desgastan rápidamente, por ambas razones se sugiere utilizar un substrato más duro.

Anexos

\mathbf{A}

HEMTECP

```
function average = HEMTECP (numSetups)
numFreq = 201;
start = 60;
extr = zeros(6);
intr = zeros(7, numSetups); \\
Parameters = zeros(13, numSetups);
average = zeros(13,numSetups);
parName(1,:) = 'Rs ';
parName(2,:) = 'Rg ';
parName(3,:) = 'Rd ';
parName(4,:) = 'Ls';
parName(5,:) = 'Lg ';
parName(6,:) = 'Ld ';
parName(7,:) = 'Cgd';
parName(8,:) = 'Cgs';
parName(9,:) = 'Cds';
parName(10,:) = 'Ri';
parName(11,:) = 'gm';
parName(12,:) = 'gd';
parName(13,:) = 't';
extr = EXTR(strcat('pinchedData(1).s2p'),start);
for k = 1:numSetups
intr(:,k) = INTR(strcat('data','(',k+48,')','.s2p'),extr,start);
end
for h = 1:numSetups
for k = 1:6
average(k,h) = extr(k);
end
for k = 1:7
average(k+6,h) = intr(k);
end
end
end
```

EXTR

```
function parameters = EXTR(fileS2pPinch,start)
pinchData = read(rfdata.data,fileS2pPinch);
s\_params = pinchData.S\_Parameters;
numFreq = size(s_params, 3);
freq = pinchData.Freq;
freq = freq;

w = freq^2 *pi();
z0 = pinchData.z0;
z_params = s2z(s_params,z0);
Ls = zeros(numFreq);
Lg = zeros(numFreq);
Ld = zeros(numFreq);
Rs = zeros(numFreq);
Rg = zeros(numFreq);
Rd = zeros(numFreq);
LS = 0;
LG = 0;
LD = 0;
RS = 0;
RG = 0;
RD = 0;
for \; k = start:numFreq
Ls(k)=imag(z_params(1,2,k))*w(k);
Lg(k)=imag(z_params(1,1,k))*w(k);
Ld(k)=imag(z\_params(2,2,k))*w(k);
end LS = (Ls(200)-Ls(140))/(w(200)\hat{2}-w(140)\hat{2});
LG = (Lg(200)-Lg(140))/(w(200)\hat{2}-w(140)\hat{2})-LS;
LD = (Ld(200)-Ld(140))/(w(200)\hat{2}-w(140)\hat{2})-LS;
for k = start:numFreq
Rs(k)=[real(z_params(1,2,k))];
Rg(k) = [real(z_params(1,1,k)) - Rs(k)];
Rd(k) = [real(z_params(2,2,k)) - Rs(k)];
end
for k = start:numFreq
RS = RS + Rs(k);
RG = RG + Rg(k);
RD = RD + Rd(k);
end
RS = RS/(numFreq-start);
RG = RG/(numFreq-start);
RD = RD/(numFreq-start);
parameters(1) = RS;
parameters(2) = RG;
parameters(3) = RD;
parameters(4) = LS;
parameters(5) = LG;
parameters(6) = LD;
\quad \text{end} \quad
```

INTR.

```
function parameters = INTR (fileS2pActive,extr,start) activeData = read(rfdata.data,fileS2pActive);
s_params = activeData.S_Parameters;
numFreq = size(s\_params,3);
freq = activeData.Freq;
\dot{w} = freq^2 * pi();
z0 = activeData.z0;
Rs = 1; Rg = 2; Rd = 3; Ls = 4; Lg = 5; Ld = 6;
Cgd = zeros(numFreq-start); Cgs = zeros(numFreq-start); Cds = zeros(numFreq-start); Ri = zeros(numFreq-start);
gm = zeros(numFreq-start); gd = zeros(numFreq-start); t = zeros(numFreq-start);
CGD = 0; CGS = 0; RI = 0; GM = 0; GD = 0; CDS = 0; T = 0;
z_params = s2z(s_params,z0);
for k = start:numFreq
z\_params(1,1,k) = z\_params(1,1,k) - i^*w(k)^*extr(Lg);
z_{params}(2,2,k) = z_{params}(2,2,k)-i*w(k)*extr(Ld);
y_params = z2y(z_params);
z_params = y2z(y_params);
for k = start:numFreq
z_{params}(1,1,k) = z_{params}(1,1,k)-extr(Rs)-extr(Rg)-i*w(k)*extr(Ls);
z_{params}(1,2,k) = z_{params}(1,2,k)-extr(Rs)-i*w(k)*extr(Ls);
z_{params}(2,1,k) = z_{params}(2,1,k)-extr(Rs)-i*w(k)*extr(Ls);
z_{params}(2,2,k) = z_{params}(2,2,k)-extr(Rs)-extr(Rd)-i*w(k)*extr(Ls);
y_params = z2y(z_params);
for k = start:numFreq
Cgd(k) = -1*imag(y\_params(1,2,k))/w(k);
Cgs(k) = imag(y\_params(1,1,k))/w(k)-Cgd(k);
Ri(k) = real(y_params(1,1,k))/(Cgs(k)\hat{2}*w(k)\hat{2});
gm(k) = real(y\_params(2,1,k));
t(k) = (-1*imag(y\_params(2,1,k))/w(k)-Cgd(k))/gm(k)-Ri(k)*Cgs(k);
gd(k) = real(y_params(2,2,k));
Cds(k) = imag(y\_params(2,2,k))/w(k)\text{-}Cgd(k);
for k = start:numFreq
\mathrm{CGD} = \mathrm{CGD} + \mathrm{Cgd}(k);
CGS = CGS + Cgs(k);
RI = RI + Ri(k);
GM = GM + gm(k);
GD = GD + gd(k);
CDS = CDS + Cds(k);
T = T + t(k);
end
CGD = CGD/(numFreq-start);
CGS = CGS/(numFreq-start);
RI = RI/(numFreq-start);
GM = GM/(numFreq-start);
GD = GD/(numFreq-start);
CDS = CDS/(numFreq-start);
T = T/(numFreq-start);
parameters(1) = CGD;
parameters(2) = CGS;
parameters(3) = CDS;
parameters(4) = RI;
parameters(5) = GM;
parameters(6) = GD;
parameters(7) = T;
end
```

Referencias

- [1] D. M. Pozar, Microwave Engineering, tercera ed. John Wiley & Sons, Inc., 2005.
- [2] S. Marsh, *Practical MMIC Design*. Artech House, Inc., 2006.
- [3] I. Bahl and P. Bhartia, Microwave Solid State Circuit Design, segunda ed. John Wiley & Sons, Inc., 2003.
- [4] F. H. Gilles Dambrine, Alain Cappy and E. Playez, "A new method for determining the fet small-signal equivalent circuit," *IEEE Transactions On Microwave Theory And Techniques*, vol. 36, no. 7, Julio 1988.
- [5] H. I. Shigeru Yanagawa and M. Ohtomo, "Analytical method for determining equivalent circuit parameters of gaas fet's," *IEEE Transactions On Microwave Theory And Techniques*, vol. 44, no. 10, Octubre 1996.
- [6] PE44221 datasheet. [Online]. Available: http://www.pasternack.com/product-2.4mm-Male-4-Hole-Panel-Mount-.250-Extended-Dielectric-PE44221-70408.html
- [7] PE44218 datasheet. [Online]. Available: http://www.pasternack.com/product-2.4mm-Female-4-Hole-Panel-Mount-.250-Extended-Dielectric-PE44218-70404.html
- [8] PE4001 datasheet. [Online]. Available: http://www.pasternack.com/product-SMA-Female-2-Hole-Panel-Mount-Stub-Contact-Extended-Dielectric-PE4001-69781.html
- [9] EC2612 datasheet. [Online]. Available: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/33018/UMS/EC2612.html

- [10] United Monolithic Semiconductors. [Online]. Available: http://www.ums-gaas.com
- [11] RT/duroid 6002 datasheet. [Online]. Available: http://www.rogerscorp.com/documents/609/acm/RT-duroid-6002-laminate-datasheet.aspx
- [12] Rogers Corporation. [Online]. Available: http://www.rogerscorp.com
- [13] C. Jarufe, "Diseño y fabricacion de un amplificador de microondas de bajo ruido para la banda de 31-45 Ghz," Memoria Ingenieria, Universidad de Chile, Santiago, Chile, Abril 2010.
- [14] Kulicke & Soffa. [Online]. Available: http://www.kns.com
- [15] Polyflon. [Online]. Available: http://www.polyflon.com
- [16] Mathworks. [Online]. Available: http://www.mathworks.com/
- [17] Pasternack Enterprises, Inc. [Online]. Available: http://www.pasternack.com
- [18] Allwin Technology. [Online]. Available: http://www.allwintek.com